

XV

РОССИЙСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ФИЗИКЕ
ПОЛУПРОВОДНИКОВ

ПРОГРАММА



Нижний Новгород
2022

XV РОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИЗИКЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

3 – 7 октября 2022 года, Нижний Новгород

ПРОГРАММА

Нижний Новгород, 2022

Программный комитет

Председатель – Е. Л. Ивченко, ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург
Ученый секретарь – М. М. Глазов, ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург

А. А. Андронов, ИФМ РАН, Нижний Новгород
А. Л. Асеев, ИФП им. А. В. Ржанова СО РАН, Новосибирск
В. А. Волков, ИРЭ им. В. А. Котельникова РАН, Москва
С. В. Гапонов, ИФМ РАН, Нижний Новгород
А. А. Гиппиус, ФИАН им. П. Н. Лебедева, Москва
А. А. Горбачевич, ФИАН им. П. Н. Лебедева, Москва
А. В. Двуреченский, ИФП им. А. В. Ржанова СО РАН, Новосибирск
В. С. Днепровский, МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва
А. Г. Забродский, ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург
С. В. Зайцев-Зотов, ИРЭ им. В. А. Котельникова РАН, Москва
А. А. Каплянский, ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург
В. В. Кведер, ИФТТ им. Ю. А. Осипьяна РАН, Черногловка
П. С. Копьев, ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург
З. Ф. Красильник, ИФМ РАН, Нижний Новгород
Г. Я. Красников, ОАО «НИИМЭ и Микрон», Зеленоград
И. В. Кукушкин, ИФТТ им. Ю. А. Осипьяна РАН, Черногловка
В. Д. Кулаковский, ИФТТ им. Ю. А. Осипьяна РАН, Черногловка
Л. В. Кулик, ИФТТ им. Ю. А. Осипьяна РАН, Черногловка
Ю. Г. Кусраев, ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург
А. В. Латышев, ИФП им. А. В. Ржанова СО РАН, Новосибирск
И. Г. Неизвестный, ИФП им. А. В. Ржанова СО РАН, Новосибирск
В. И. Окулов, ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
В. Я. Покровский, ИРЭ им. В. А. Котельникова РАН, Москва
А. А. Саранин, ИАПУ ДВО РАН, Владивосток
Р. А. Сурис, ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург
А. С. Терехов, ИФП им. А. В. Ржанова СО РАН, Новосибирск
В. Б. Тимофеев, ИФТТ им. Ю. А. Осипьяна РАН, Черногловка
В. М. Устинов, ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург
Д. Р. Хохлов, МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва
А. В. Чаплик, ИФП им. А. В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

Организационный комитет

Председатель – А. В. Новиков, ИФМ РАН, Нижний Новгород
Заместитель председателя – В. И. Гавриленко, ИФМ РАН, Нижний Новгород
Ученый секретарь – А. А. Дубинов, ИФМ РАН, Нижний Новгород

Р. С. Малофеев, ИФМ РАН, Нижний Новгород
А. В. Иконников, МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва
С. В. Морозов, ИФМ РАН, Нижний Новгород
В. В. Румянцев, ИФМ РАН, Нижний Новгород
Д. А. Камелин, ИФМ РАН, Нижний Новгород
М. В. Зорина, ИФМ РАН, Нижний Новгород
Е. А. Архипова, ИФМ РАН, Нижний Новгород
А. Г. Милехин, ИФП им. А. В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

Контакты оргкомитета

Нижний Новгород, 603950, ГСП-105, Институт физики микроструктур РАН.
Электронная почта: semicond@semicond2022.ru
Телефоны: (831) 417-94-82 (+234), (831) 417-94-76 (+520), +79107968950
Факс: (831) 417-94-64

Трансфер во время проведения конференции

Для участников, не проживающих в санатории «Автомобилист», во время конференции будет организован трансфер от ближайшего крупного населенного пункта г. Бор до санатория. Из Нижнего Новгорода до г. Бор можно добраться электричкой (до станции «Моховые горы»), по канатной дороге или пригородным автобусом.

Расписание движения автобусов Оргкомитета из г. Бор до санатория «Автомобилист» и обратно 3–7 октября

1) **г. Бор – санаторий «Автомобилист». Отправление в 8:40** от станции канатной дороги, г. Бор; **отправление в 9:00** от ж/д ст. «Моховые горы», г. Бор (к электричке, прибывающей на станцию «Моховые горы» в 8:49 с отправлением из Нижнего Новгорода в 8:10).

2) **Санаторий «Автомобилист» – г. Бор. Отправление в 19:20** от санатория «Автомобилист» до ж/д ст. «Моховые горы», г. Бор (к электричке, отправляющейся от станции «Моховые горы» в 20:28, с прибытием в Нижний Новгород в 21:03), и станции канатной дороги, г. Бор.

Расписание работы канатной дороги «г. Н. Новгород — г. Бор»:

понедельник – суббота с **6:45 до 22:00**, воскресенье и праздничные дни с **9:00 до 22:00**, по понедельникам и четвергам технический перерыв с 10:45 до 13:00. Стоимость проезда – 100 рублей.

Телефон справочной канатной дороги: +7 (831) 411-10-09.

Борская станция канатной дороги находится недалеко от пересечения ул. Профсоюзной и Ленина.

Спонсоры конференции



Группа компаний НТ-МДТ
Спектрум Инструментс
ntmdt-si.ru



ООО «Серния Инжиниринг»
sernia.ru



ООО «Криогенные приборы», cryopribor.ru



ООО «АкадемВак»
academvac.ru



ГК «Диполь», dipaul.ru

Расписание конференции

3 октября, понедельник		4 октября, вторник		5 октября, среда		6 октября, четверг		7 октября, пятница	
		9:00 – 11:10		9:00 – 10:50		9:00 – 13:30		9:00 – 10:50	
		Зал А-3 Секция 3	Зал Б-3 Секция 6	Зал А-6 Секция 6	Зал Б-6 Секция 10	Экскурсия в Нижний Новгород или в ИФМ РАН		Зал А-10 Секции 10, 11	Зал Б-10 Секции 8, 12
		11:10 – 11:30 Coffee-break		10:50 – 11:10 Coffee-break				10:50 – 11:20 Coffee-break	
11:00 – 11:15		11:30 – 13:05		11:10 – 11:50				11:20 – 13:30	
Открытие конференции		Зал А-4 Секция 11	Зал Б-4 Секция 9	Пленарный доклад 2				Зал А-11 Секция 8	Зал Б-11 Секция 9
11:15 – 11:55									
Пленарный доклад 1				12:00 – 13:10		13:45 – 14:00			
12:10 – 13:45				Зал А-7 Секция 1		Зал Б-7 Секция 3			
Обед с 13:45		Обед с 13:05		Обед с 13:10		Обед с 13:30		Обед с 14:00	
15:00 – 17:00		14:30 – 16:20		14:30 – 16:40		15:00 – 17:10		15:30	
Зал А-2 Секция 1	Зал Б-2 Секция 7	Зал А-5 Секция 4	Зал Б-5 Секция 5	Зал А-8 Секция 11	Зал Б-8 Секция 13	Зал А-9 Секция 4	Зал Б-9 Секция 2	Отъезд участников	
17:00 – 17:30 Coffee-break		16:20 – 17:00 Coffee-break		16:40 – 17:00 Coffee-break		17:10 – 17:30 Coffee-break			
17:30 – 19:30		17:00 – 19:00		17:00 – 18:40		17:30 – 19:30			
1-я стендовая сессия Секции 3, 11		2-я стендовая сессия Секции 2, 7, 12		3-я стендовая сессия Секции 1, 6, 8, 9		4-я стендовая сессия Секции 4, 5, 10, 13			
Ужин 19:30 – 20:30		Ужин 19:00 – 20:00		Банкет 19:00 – 22:00		Ужин 19:30 – 20:30			

ПРОГРАММА

3 октября, понедельник

11:00-11:15	Открытие конференции	
11:15-11:55	Пленарный доклад. В.И. Гавриленко. <i>Фундаментальные свойства структур на основе HgTe</i> Председатель Е.Л. Ивченко	
Заседание 1	А: Двумерные системы – 1 Председатель В.Я. Алешкин	Б: Нанопотоника-1 Председатель Л.В. Кулик
12:10-12:35	(Пр.) Ваньков А.Б. , Кукушкин И.В. <i>Спиновые экситоны с аномальной дисперсией и макрозаполнением в квантово-холловском ферромагнетике (онлайн)</i>	(Пр.) Двуреченский А.В. , Якимов А.И., Новиков А.В. <i>Метаматериалы в управлении характеристиками компонент нанопотоники на основе кремния с квантовыми точками</i>
12:35-12:50	Миньков Г.М. , Алешкин В.Я., Шерстобитов А.А., Рут О.Э., Михайлов Н.Н., Дворецкий С.А. <i>Транспортные явления в квантовых ямах HgTe с двумя (верхним и нижним) полевыми электродами</i>	Дмитриева О.А., Гиппиус Н.А., Тиходеев С.Г. <i>Нелинейно-оптические свойства экситон-поляритонов в кирально-модулированном микрорезонаторе</i>
12:50-13:05	Якунин М.В. , Алешкин В.Я., Подгорных С.М., Попов М.Р., Неверов В.Н., Михайлов Н.Н., Дворецкий С.А. <i>Особенности магнитотранспорта в двойных квантовых ямах p-HgTe/CdHgTe</i>	Галимов А.И., Рахлин М.В., Елисеев И.А., Пошакинский А.В., Бородин Б.Р., Серов Ю.М., Казанов Д.Р., Шубина Т.В. <i>Экситон-поляритоны в спиральных трубках MoS₂</i>
13:05-13:20	Капралов К.Н. , Свинцов Д.А. <i>Баллистически-гидродинамический переход и коллективные моды в двумерных электронных системах в магнитном поле</i>	Загороднев И.В. , Родионов Д.А., Заболотных А.А. <i>Плазмон-поляритонные моды проводящего диска</i>

13:20-13:45	(Пр.) Волков В.А. , Заболотных А.А., Еналдиев В.В. <i>Свойства двумерных экранированных магнитоплазмонов и магнитоплазмон-поляритонов (онлайн)</i>	(Пр.) Новиков А.В. , Степихова М.В., Дьяков С.А., Юрасов Д.В., Шалеев М.В., Яблонский А.Н., Перегокин А.В., Вербус В.А., Скороходов Е.В., Родякина Е.Е., Красильник З.Ф. <i>Высокодобротные моды в диэлектрических микрорезонаторах на основе светоизлучающих гетероструктур SiGe</i>
13:45-15:00	Обед	
Заседание 2	А: Объемные полупроводники – 1 Председатель В.Я. Покровский	Б: Примеси и дефекты Председатель Г.Н. Гольцман
15:00-15:15	Папроцкий С.К., Алтухов И.В., Каган М.С. , Родионов Н.Б., Паль А.Ф., Большаков А.П., Ральченко В.Г., Хмельницкий Р.А. <i>Проводимость пленок монокристаллического алмаза, слабо легированного бором</i>	Шастин В.Н. , Жукавин Р.Х., Бушуйкин П.А., Ковалевский К.А., Цыпленков В.В., Бекин Н.А., Deßmann N., Астров Ю.А. <i>Кинетика неравновесных состояний двойных доноров в кремнии</i>
15:15-15:30	Кон И.А., Майзлах А.А., Соболевский О.А., Усольцев А.С., Зайцев-Зотов С.В. <i>Магнетосопротивление при движении волны зарядовой плотности в квазиодномерных проводниках o-TaS₃ и вейлевском полуметалле (TaSe₄)₂I</i>	Жукавин Р.Х. , Бушуйкин П.А., Кукотенко В.В., Чопорова Ю.Ю., Deßmann N., Ковалевский К.А., Румянцев В.В., Цыпленков В.В., Герасимов В.В., Князев Б.А., Шастин В.Н. <i>Осцилляции Рамсея в германии, легированном мышьяком</i>
15:30-15:45	Андреев Б.А., Кудрявцев К.Е., Калинников М.А., Лобанов Д.Н. , Новиков А.В., Скороходов Е.В., Юнин П.А., Красильник З.Ф. <i>Стимулированное излучение ИК-диапазона в слоях InGaN, полученных методом МПЭ ПА</i>	Пошакинский А.В. , Бреев И.Д., Shang Z., Berencsén Y., Hollenbach M., Нагалюк С.С., Мохов Е.Н., Бабунц Р.А., Баранов П.Г., Тарасенко С.А., Астахов Г.В., Анисимов А.Н. <i>Тонкая структура возбужденных уровней кремниевых вакансий в карбиде кремния</i>

15:45-16:00	Кудрявцев К.Е. , Лобанов Д.Н., Калинин М.А., Шенгуров Д.В., Морозова Е.Е., Яблонский А.Н., Юнин П.А., Андреев Б.А., Новиков А.В., Красильник З.Ф. <i>Эпитаксиальные слои InGaN для лазеров ИК-диапазона: анализ фотолюминесценции и оптического усиления</i>	Гудков В.В. , Аверкиев Н.С., Жевстовских И.В., Сарычев М.Н. <i>Влияние пьезоэлектричества на эффект Яна – Теллера в легированных кристаллах</i>
16:00-16:15	Горлова И.Г. , Никонов С.А., Зыбцев С.Г., Покровский В.Я. <i>Фотопроводимость слоистого квазиодномерного полупроводника TiS_3</i>	Жолудев М.С. , Морозов С.В. <i>Расчёт локализованных и резонансных состояний акцепторов в твёрдом растворе $CdHgTe$</i>
16:15-16:30	Шульман А.Я. <i>О релаксации неравновесных носителей в биполярном полупроводнике с ловушками (онлайн)</i>	Аверкиев Н.С. , Гуткин А.А. <i>Микроскопическая модель комплекса $VGa-TeAs$ в $n-GaAs$</i>
16:30-16:45	Крайнов И.В. , Дмитриев А.П., Горный И.В., Аверкиев Н.С. <i>Дробовый шум в резонансном туннелировании. Случай неупругого рассеяния</i>	Лебедев А.А., Козловский В.В., Давыдовская К.С., Левинштейн М.Е., Кузьмин Р.А. <i>Влияние температуры облучения на процессы радиационного дефектообразования в SiC</i>
16:45-17:00	Груздев Н.Б. , Соколов В.И., Меньшенин В.В., Савченко С.С., Вохминцев А.С., Вайнштейн И.А., Емельченко Г.А. <i>Влияние температуры на линии локальных экситонов в оксиде цинка, легированном марганцем (онлайн)</i>	Кокурин И.А. , Аверкиев Н.С. <i>Многоцентровые акцепторные комплексы и их влияние на люминесценцию в кубических полупроводниках</i>
17:00-17:30	C o f f e e - b r e a k	
17:30-19:30	1-я стендовая сессия. Гетероструктуры и сверхрешетки. Полупроводниковые приборы и устройства	
19:30-20:30	У ж и н	

4 октября, вторник

Заседание 3	А: Гетероструктуры и сверхрешетки – 1 Председатель С.В. Морозов	Б: Спиновые явления – 1 Председатель А.Б. Ваньков
9:00-9:25	(Пр.) Алешкин В.Я. , Дубинов А.А., Рудаков А.О., Гавриленко В.И. <i>Плазмонные поляритоны в $HgTe/CdHgTe$ гетероструктурах с квантовыми ямами</i>	(Пр.) Русецкий В.С., Голяшов В.А., Кустов Д.А., Еремеев С.В., Шамирзаев Т.С., Миронов А.В., Демин А.Ю., Терещенко О.Е. <i>Новый полупроводниковый источник спин-поляризованных электронов и спин-детектор с пространственным разрешением</i>
9:25-9:40	Михайлов Н.Н. , Дворецкий С.А., Ремесник В.Г., Ужаков И.Н., Швец В.А., Алешкин В.Я. <i>Энергетическое положение уровней размерного квантования в структурах с множественными $Cd_xHg_{1-x}Te$ квантовыми ямами</i>	Шамирзаев Т.С. , Глазов М.М., Яковлев Д.Р., Bayer M. <i>Спиновая динамика носителей заряда в непрямозонных квантовых ямах</i>
9:40-9:55	Фадеев М.А. , Кудрявцев К.Е., Румянцев В.В., Уточкин В.В., Алешкин В.Я., Дубинов А.А., Жолудев М.С., Михайлов Н.Н., Дворецкий С.А., Морозов С.В. <i>Вынужденное излучение в волноводных гетероструктурах с квантовыми ямами $Hg(Cd)Te/CdHgTe$ в диапазоне 3–6 мкм</i>	Калитуха И.В. , Кен О.С., Коренев В.Л., Акимов И.А., Сапега В.Ф., Яковлев Д.Р., Дмитриев Г.С., Langer L., Karczewski G., Chusnutdinov S., Wojtowicz T., Bayer M. <i>Сосуществование короткодействующего и дальнедействующего ферромагнитных эффектов близости в гибридной структуре $Fe/CdTe$ квантовая яма</i>
9:55-10:10	Румянцев В.В. , Алешкин В.Я., Кудрявцев К.Е., Андронов Е.В., Гавриленко В.И., Михайлов Н.Н., Дворецкий С.А., Морозов С.В. <i>Исследование безызлучательных механизмов рекомбинации в структурах с КЯ на основе $HgCdTe$</i>	Белых В.В. , Скориков М.Л., Кулебякина Е.В., Колобкова Е.В., Кузнецова М.С., Глазов М.М., Яковлев Д.Р. <i>Субмиллисекундная спиновая релаксация в нанокристаллах перовскитов $CsPb(Cl,Br)_3$ в стеклянной матрице (онлайн)</i>

10:10-10:25	Коваль О.Ю. , Федина С.В., Федоров В.В. <i>Аксиально-гетероструктурированные нитевидные нанокристаллы GaPN/GaP: оптические свойства</i>	Хисамеева А.Р. , Лопатина С.А., Николаев Г.А., Щепетильников А.В., Кукушкин И.В. <i>Спиновые и псевдоспиновые ферромагнитные фазовые переходы в режиме квантового эффекта Холла</i>
10:25-10:40	Резник Р.Р. , Цырлин Г.Э. <i>InGaAs квантовые точки в AlGaAs нитевидных нанокристаллах на поверхности кремния(онлайн)</i>	Будкин Г.В. , Тарасенко С.А. <i>Новый тип спин-орбитального расщепления в низкосимметричных квантовых ямах</i>
10:40-10:55	Джигирба К.Р., Астраханцева А.С., Гусихин П.А., Кукушкин И.В., Муравьев В.М. <i>Высокочастотные моды сверхрезонатора Фабри – Перо</i>	Рожанский И.В. , Денисов К.С., Ракицкий М.А. <i>Особенности асимметричного рассеяния электронов и дырок в полупроводниках (онлайн)</i>
10:55-11:10	Дворецкий С.А. , Михайлов Н.Н., Варавин В.С., Ремесник В.Г., Ступак М.Ф., Макаров С.Н., Елесин А.Г., Верхогляд А.Г. <i>Новые центры рекомбинации в слоях МЛЭ КРТ на подложках (013) GaAs (онлайн)</i>	
11:10-11:30	C o f f e e - b r e a k	
Заседание 4	А: Полупроводниковые приборы и устройства – 1 Председатель А.Г. Милехин	Б: Атомарно-тонкие полупроводники – 1 Председатель А.А. Саранин
11:30-11:55	(Пр.) Морозов С.В. , Румянцев В.В., Алешкин В.Я., Фадеев М.А., Уточкин В.В., Разова А.А., Кудрявцев К.Е., Жолудев М.С., Дубинов А.А., Гавриленко В.И., Дворецкий С.А., Михайлов Н.Н. <i>Лазеры на основе гетероструктур с квантовыми ямами HgCdTe/CdHgTe для среднего и дальнего ИК-диапазонов</i>	(Пр.) Голуб Л.Е. , Леппенен Н.В., Ивченко Е.Л. <i>Кулоновские эффекты в поглощении света в дираковских материалах (онлайн)</i>

11:55-12:20	(Пр.) Хабибуллин Р.А. , Афоненко А.А., Ушаков Д.В., Пушкарев С.С., Галиев Р.Р., Пономарев Д.С., Васильевский И.С., Клочков А.Н., Виниченко А.Н., Ладугин М.А., Багаев Т.А., Мармалюк А.А., Маремьянин К.В., Гавриленко В.И. <i>Эффективные зонные дизайны квантово-каскадных лазеров терагерцового диапазона(онлайн)</i>	(Пр.) Еналдиев В.В. <i>Влияние релаксации решетки на электронные и оптоэлектронные свойства слабо разориентированных бислоев дихалькогенидов переходных металлов (онлайн)</i>
12:20-12:35	Колодезный Е.С. , Бабичев А.В., Михайлов Д.А., Гладышев А.Г., Вознюк Г.В., Митрофанов М.И., Слипченко С.О., Лютецкий А.В., Дюделев В.В., Евтихий В.П., Карачинский Л.Я., Новиков И.И., Соколовский Г.С., Пихтин Н.А., Егоров А.Ю. <i>Поверхностно-излучающие квантово-каскадные лазеры с дифракционной решеткой, изготовленной методом травления сфокусированным ионным пучком (онлайн)</i>	Кравцов В.А. , Кондратьев В.И., Иорш И.В. <i>Управление нелинейными экситон-поляритонами в резонаторах на основе атомарно-тонких полупроводников</i>
12:35-12:50	Дюделев В.В., Михайлов Д.А., Черотченко Е.Д., Чистяков Д.В., Бабичев А.В., Мыльников В.Ю., Гладышев А.Г., Лосев С.Н., Новиков И.И., Лютецкий А.В., Слипченко С.О., Пихтин Н.А., Карачинский Л.Я., Егоров А.Ю., Соколовский Г.С. <i>Мощные квантово-каскадные лазеры среднего инфракрасного диапазона</i>	Котова Л.В. , Алтынбаев Л.А., Жукова М.О., Бородин Б.Р., Ноган В.Т., Балдычева А., Кочерешко В.П. <i>Анизотропия оптических свойств тонких пленок гексагонального нитрида бора</i>
12:50-13:05	Дубинов А.А. , Ушаков Д.В., Афоненко А.А., Хабибуллин Р.А., Морозов С.В. <i>Сверхкомпактный терагерцовый квантово-каскадный лазер на основе гетероструктуры HgCdTe</i>	Яковлев З.А. , Глазов М.М., Семина М.А., Шерман Е.Я. <i>Межслоевой экситонный полярон в атомарно-тонких полупроводниках</i>

13:05-14:30	Обед	
Заседание 5	А: Двумерные системы – 2 Председатель С.А. Тарасенко	Б: Нульмерные системы Председатель В.К. Калевич
14:30-14:55	(Пр.) Энтин М.В. , Махмудиан М.М., Махмудиан М. <i>Структура и динамические свойства двумерного вигнеровского кластера (онлайн)</i>	(Пр.) Милёхин А.Г. , Курусъ Н.Н., Аникин К.В., Родякина Е.Е., Васильев Р.Б., Milekhin I.A., Zahn D.R.T., Латышев А.В. <i>Наноскопия полупроводниковых наноструктур</i>
14:55-15:20	(Пр.) Кулик Л.В. <i>Нейтральные возбуждения в лафлиновской жидкости</i>	(Пр.) Смирнов Д.С. , Шумилин А.В., Шамирзаев Т.С., Яковлев Д.Р. <i>Динамическая спиновая и долинная поляризация локализованных электронов</i>
15:20-15:35	Титова Е.И. , Мыльников Д.А., Кащенко М.А., Алымов Г.В., Жуков С.С., Свинцов Д.А. <i>ТГц-детектирование на p-n-переходе в двуслойном графене с открытой запрещенной зоной</i>	Смирнова О.О. , Калитухо И.В., Родина А.В., Дмитриев Г.С., Сапега В.Ф., Кен О.С., Коренев В.Л., Козырев Н.В., Некрасов С.В., Кусраев Ю.Г., Яковлев Д.Р., Вауер М. <i>Оптическое выстраивание и оптическая ориентация экситонов в ансамбле коллоидных наноплателетов CdSe/CdS</i>
15:35-15:50	Морозов М.Ю. , Попов В.В. <i>Усиление терагерцевых плазменных волн в желобковом металлическом волноводе с графеном</i>	Мингаиров А.М. , Лебедев Д.В., Власов А.С., Blundell S. <i>Энионные состояния в спектрах магнитофотолюминесценции самоорганизованных квантовых точек InP/GaInP₂</i>

15:50-16:05	Похабов Д.А. , Погосов А.Г., Сарыпов Д.И., Жданов Е.Ю., Бакаров А.К., Шкляев А.А. <i>Спонтанная структуризация канала квантового точечного контакта, обусловленная межэлектронным взаимодействием</i>	Казанцев Д.М., Альперович В.Л. , Ткаченко В.А., Квон З.Д. <i>Максимум в спектре фотоотклика квантового точечного контакта с плавным потенциальным барьером (онлайн)</i>
16:05-16:20	Иконников А.В. , Криштопенко С.С., Бовкун Л. С., Михайлов Н.Н., Дворецкий С. А., Piot V. A., Potemski M., Orlita M., Terpe F., Гавриленко В. И. <i>Природа структурной асимметрии в двойных квантовых ямах HgTe/CdHgTe (онлайн)</i>	Манцевич В.Н. , Маслова Н.С. <i>Перепутанные состояния в коррелированных квантовых точках</i>
16:20-17:00	Coffee - break	
17:00-19:00	2-я стендовая сессия. Поверхность, пленки, слои. Примеси и дефекты. Нано- и оптомеханика	
19:00-20:00	Ужин	

5 октября, среда

Заседание 6	А: Спиновые явления – 2 Председатель Д.С. Смирнов	Б: Нанопотоника-2 Председатель А.В. Двуреченский
9:00-9:25	(Пр.) Запасский В.С. <i>Спектроскопия спиновых шумов: избранные сюжеты</i>	(Пр.) Гольцман Г.Н. <i>На пути к масштабируемым и полнофункциональным квантово-фотонным схемам на полупроводниковом кристалле</i>
9:25-9:40	Шестаков А.В. , Яцдык И.В., Еремина Р.М., Пиллюк Е.А., Захвалинский В.С. <i>Особенности спектров ЭПР ZnMn₂As₂</i>	Максимов А.А. , Филатов Е.В., Тартаковский И.И. <i>Искусственно созданные компактные источники циркулярно-поляризованного света на основе хиральных полупроводниковых гетероструктур</i>
9:40-9:55	Денисов К.С., Барыш- ников К.А. , Алексеев П.С. <i>Метод обнаружения вязкой электронной жидкости по пространственному распределению спиновой поляризации</i>	Мыльников Д.А. , Свинцов Д.А. <i>О предельных возможностях двумерной плазмоники в приложениях фотодетектирования</i>
9:55-10:10	Богословский Н.А., Петров П.В. , Аверкиев Н.С. <i>Неупорядоченная модель Изинга: от численного моделирования к аналитическому решению</i>	Алексеев П.А. , Бородин Б.Р., Елисеев И.А., Смирнов А.Н., Бенимецкий Ф.А., Богданов А.А., Лепешов С., Пидгайко Д., Давыдов В.Ю. <i>Фотонные резонаторы на основе MoSe₂-наноструктур</i>
10:10-10:25	Родина А.В. , Ивченко Е.Л. <i>Теория неупругого рассеяния света с многократным переворотом спинов локализованных носителей заряда</i>	Рахлин М.В. , Галимов А.И., Дьяконов И.В., Скрыбин Н.Н., Климко Г.В., Кулагина М.М., Задиранов Ю.М., Тараторин К.В., Скалкин А.К., Страупе С.С., Кулик С.П., Торопов А.А. <i>Источник одиночных фотонов с пространственно-временным демультиплексированием на основе квантовой точки в микрорезонаторе (онлайн)</i>

10:25-10:50	(Пр.) Сапожников М.В. , Гусев Н.С., Гусев С.А., Фраерман А.А., Петров Ю.В., Темирязов А.Г. <i>Топологический эффект Холла в наноструктурированных магнитных пленках</i>	(Пр.) Калевич В.К. , Лукошкин В.А., Седов Е.С., Savvidis P.G., Кавокин А.В. <i>Незатухающие циркулярные токи в экситон-поляритонных конденсатах с целочисленными и дробными орбитальными угловыми моментами</i>
10:50-11:10	Coffee-break	
11:10-11:50	Пленарный доклад. Г.Я. Красников. <i>Физика и технология современных транзисторных структур</i> Председатель З.Ф. Красильник	
Заседание 7	А: Объемные полупроводники – 2 Председатель С.В. Зайцев-Зотов	Б: Гетероструктуры и сверхрешетки – 2 Председатель О.В. Кибис
12:00-12:25	(Пр.) Козлов Д.А. , Савченко М.Л., Квон З.Д., Михайлов Н.Н., Дворецкий С.А. <i>Квантовый эффект Холла в трехмерной пленке HgTe (онлайн)</i>	(Пр.) Тарасенко С.А. <i>Циркулярная поляризация фотолюминесценции закрученных ван-дер-ваальсовых гетероструктур</i>
12:25-12:40	Козлов Д.В. , Иконников А.В., Румянцев В.В., Уаман- Светикова Т.А., Разова А.А., Жолудев М.С., Михайлов Н.Н., Дворецкий С.А., Гавриленко В.И., Морозов С.В. <i>Фототермическая ионизационная спектроскопия вакансий ртути в эпитаксиальных слоях HgCdTe</i>	Покровский В.Я. , Зыбцев С.Г., Никонов С.А. <i>Линейная и нелинейная фотопроводимость квазиодномерных проводников с волной зарядовой плотности</i>
12:40-12:55	Жевстовских И.В. , Аверкиев Н.С., Сарычев М.Н., Семенова О.И., Голяшов В.А., Терещенко О.Е. <i>Фазовый переход в гибридном металл-органическом перовските: упругие и оптические свойства</i>	Маслов А.Ю. , Прошина О.В. <i>Поляронные эффекты в тонкой пленке на ионных подложках (онлайн)</i>

12:55-13:10	Говоркова Т.Е. , Окулов В.И., Гавико В.С., Суриков В.Т. <i>Ферромагнетизм при комнатной температуре кристаллического полупроводникового соединения $Hg_{1-x}Fe_xSe$ с предельно низким содержанием примесных атомов железа ($x \leq 0.13$ ат.%) (онлайн)</i>	Попов В.П. , Антонов В.А., Тихоненко Ф.В., Толмачев К.А., Мяконьких А.В., Руденко К.В. <i>Термостабильность HZO сегнетоэлектриков в MFIS структурах (онлайн)</i>
13:20-14:30	Обед	
Заседание 8	А: Топологические изоляторы Председатель М.В. Дурнев	Б: Полупроводниковые приборы и устройства – 2 Председатель А.А. Гисматулин
14:30-14:55	(Пр.) Квон З.Д. , Худайбердиев Д.А., Михайлов Н.Н. <i>Двумерный топологический андерсоновский изолятор в квантовых ямах на основе $HgTe$</i>	Дворецкая Л.Н. , Можаров А.М., Фёдоров В.В., Мухин И.С. <i>Селективная эпитаксия материалов A_3V_5 на кремнии</i>
14:55-15:10	Казаков А.С., Галеева А.В., Артамкин А.И., Долженко Д.Е., Иконников А.В., Рябова Л.И., Банников М.А., Михайлов Н.Н., Дворецкий С.А., Данилов С.Н., Хохлов Д.Р. <i>Киральная нелокальная фотопроводимость в гетероструктурах на основе топологической фазы $Hg_{1-x}Cd_xTe$</i>	Иванов М.С. , Брылевский В.И., Смирнова И.А., Родин П.Б. <i>Пикосекундное лавинное переключение высоковольтных Si-диодов: эксперимент и численное моделирование</i>
15:10-15:25	Леппенен Н.В. , Голуб Л.Е. <i>Нелинейное оптическое поглощение и фототок на поверхностных состояниях топологических изоляторов(онлайн)</i>	Соколова З.Н. , Пихтин Н.А., Слипченко С.О., Асрян Л.В. <i>Особенности генерации излучения в полупроводниковых лазерах на квантовых ямах</i>
15:25-15:40	Сабликов В.А. , Суханов А.А. <i>Резонансы примесных состояний и резонансное рассеяние в 2D топологических материалах с дисперсией мексиканской шляпы</i>	Сёмкин В.А. , Мыльников Д.А., Титова Е.И., Жуков С.С., Свинцов Д.А. <i>Разрешение поляризации излучения на графен-металлическом переходе, калиброванным затворным напряжением</i>

15:40-15:55	Степина Н.П. , Голяшов В.А., Баженов А.О., Ненашев А.В., Терещенко О.Е., Кох К.А., Голдырева Е.С., Ищенко Д.В., Тарасов А.С., Антонова И.В., Коптев Е.С., Рыбин М.Г. <i>Структурные и магнотранспортные свойства пленок топологических изоляторов на основе халькогенидов висмута</i>	Тюхова М.П. , Саранин Д.С. <i>Перовскитные солнечные элементы с инвертированной структурой на гибкой подложке</i>
15:55-16:10	Аксенов С.В. <i>Проявление гибридации майорановских мод в эффекте Ааронова – Бома (онлайн)</i>	Саранин Д.С. , Якушева А.С., Муратов Д.С., Диденко С.И., Ди Карло А. <i>Максены $Ti_3C_2T_x$ для легирования и модификации поверхности стабилизированных перовскитных солнечных элементов</i>
16:10-16:25	Овешников Л.Н. , Давыдов А.Б., Моргун Л.А., Суслов А.В., Риль А.И., Захвалинский В.С., Кочура А.В., Пудалов В.М., Аронзон Б.А. <i>Магнетотранспорт в сверхпроводящих пленках Cd_3As_2 (онлайн)</i>	Талбанова Н.Р. , Саранин Д.С., Гостищев П.А., Лучников Л.О., Ди Карло А. <i>Полупрозрачные перовскитные солнечные элементы с верхним контактом, полученным ионно-лучевым напылением</i>
16:25-16:40	Васильев Ю.Б. , Усыкова А.А., Грешнов А.А., Михайлов Н.Н. <i>Электронный транспорт в бесщелевом кристалле $HgCdTe$ (онлайн)</i>	Слипченко С.О. , Подоскин А.А., Веселов Д.А., Николаев Д.Н., Пихтин Н.А., Копьев П.С. <i>Импульсные источники лазерного излучения кВт-уровня на основе линеек полупроводниковых лазеров (онлайн)</i>
16:40-17:00	Coffee - break	
17:00-18:40	3-я стендовая сессия. Объемные полупроводники. Спиновые явления. Атомарно-тонкие полупроводники. Высокочастотные явления в полупроводниках	
19:00-22:00	Банкет	

6 октября, четверг

9:00-13:30	Экскурсия в Нижний Новгород или в ИФМ РАН	
13:30-15:00	Обед	
Заседание 9	А: Двумерные системы – 3 Председатель Квон Зе Дон	Б: Поверхность, пленки, слои Председатель А.В. Новиков
15:00-15:15	Дричко И.Л. , Смирнов И.Ю., Суслов А.В., Baldwin K.W., Pfeiffer L.N., West K.W., Гальперин Ю.М. <i>Спин-орбитальное взаимодействие и коллективная локализация дырок в AC-магнетопроводимости в структуре p-GaAs/AlGaAs с высокой подвижностью</i>	Лебедев М.В. , Львова Т.В., Дементьев П.А., Берковиц В.Л., Смирнов А.Н., Давыдов В.Ю. <i>Модификация пространственного распределения приповерхностных потенциалов зон InP(001) и GaP(001)</i>
15:15-15:30	Семенов Н.Д. , Муравьев В.М., Андреев И.В., Заболотных А.А., Кукушкин И.В. <i>Магнитодисперсия двумерных плазмон-поляритонов (онлайн)</i>	Шварц Н.Л. , Кудрич С.В., Спирина А.А., Неизвестный И.Г. <i>Движение капель золота по вицинальной поверхности Si(111)</i>
15:30-15:45	Бурмистров И.С. , Beck A., Goldstein M. <i>Электромагнитный и гравитационный отклики в неупорядоченном двумерном электронном газе в магнитном поле</i>	Колосовский Д.А. , Дмитриев Д.В., Пономарев С.А., Торопов А.И., Журавлев К.С. <i>Формирование InAs-островков в процессе отжига подложки InP(001) в потоке мышьяка</i>
15:45-16:00	Заболотных А.А. <i>Плазмонные солитоны в экранированной 2D электронной системе</i>	Тарасов А.С. , Голяшов В.А., Ахундов И.О., Ищенко Д.В., Кожухов А.С., Кох К.А., Терещенко О.Е. <i>Универсальный метод приготовления атомарно-чистых и структурно-упорядоченных поверхностей топологических изоляторов A_3V_5</i>
16:00-16:15	Щепетильников А.В. , Хисамеева А.Р., Кукушкин И.В. <i>Спин-орбитальное взаимодействие в GaN/AlGaIn и ZnO/MgZnO гетеропереходах</i>	Альперович В.Л. , Казанцев Д.М. , Shvartsman L.D. <i>Угловые распределения электронов, эмитированных из полупроводников с отрицательным и положительным электронным сродством: влияние скачка массы</i>

16:15-16:40	(Пр.) Горбунов А.В. , Тимофеев В.Б. <i>Когерентность магнитоэкситонного конденсата в холловском диэлектрике (онлайн)</i>	(Пр.) Саранин А.А. , Грузнев Д.В., Бондаренко Л.В., Тупчая А.Ю., Матецкий А.В., Денисов Н.В., Михалюк А.Н., Иванов Ю.П., Зотов А.В. <i>Однослойный металлический $NiSi_2$, эпитаксиально встроенный в Si(111): электронные и транспортные свойства (онлайн)</i>
16:40-16:55	Ткаченко О.А. , Ткаченко В.А. , Бакшеев Д.Г., Сушков О.П. <i>Электронно-транспортные свойства мезоскопических систем с полупроводниковым искусственным графеном (онлайн)</i>	Берковиц В.Л. , Кособукин В.А., Улин В.П., Алексеев П.А., Солдатенков Ф.Ю. <i>Многообразие анизотропных плазмонных нанокластеров, образующихся на поверхности кубических полупроводников (онлайн)</i>
16:55-17:10	Витлина Р.З., Магарилл Л.И., Чаплик А.В. <i>Магнитные краевые состояния 2D электронных систем (онлайн)</i>	Климов А.Э. , Миронов А.Ю., Ахундов И.О., Голяшов В.А., Горшков Д.В., Ищенко Д.В., Пашин Н.С., Сидоров Г.Ю., Супрун С.П., Тарасов А.С., Федосенко Е.В., Шерстякова В.Н., Терещенко О.Е. <i>Эффект поля в пленочных МДП-структурах на основе $PbSnTe:In$ (онлайн)</i>
17:10-17:30	Coffee-break	
17:30-19:30	4-я стендовая сессия. Нульмерные системы. Двумерные системы. Нанофотоника. Топологические изоляторы	
19:30-20:30	Ужин	

7 октября, пятница

Заседание 10	А: Полупроводниковые приборы и устройства – 3. Нанопотоника – 3 Председатель В.М. Устинов	Б: Высококачественные явления – 1. Нано- и оптомеханика Председатель О.Е. Терещенко
9:00-9:15	Котова Л.В., Savvidis P.G., Besombes L., Кочерешко В.П. <i>Экситонные поляритоны в микрорезонаторах</i>	Осинных И.В. , Малин Т.В., Милахин Д.С., Журавлев К.С. <i>Исследование кинетики и зависимости от мощности возбуждения фотолюминесценции, обусловленной дефектами, в сильно легированных слоях AlN:Si</i>
9:15-9:40	(Пр.) Гриценко В.А., Гисматулин А.А. <i>Мемристивная память на основе оксидов и нитридов кремния</i>	(Пр.) Муравьев В.М. , Кукушкин И.В. <i>Плазмоника для систем терагерцовой электроники</i>
9:40-9:55	Деменев А.А. , Фрадкин И.М., Кулаковский В.Д., Антонов В.Н., Гиппиус Н.А. <i>Поляризационные свойства излучения InAs квантовых точек в GaAs волноводных метаструктурах с золотым фотонно-кристаллическим слоем</i>	Качоровский В.Ю. , Евсеев С.С., Бурмистров И.С., Тихонов К.С. <i>Упругая блокада в одноэлектронном транзисторе</i>
9:55-10:10	Шубин Н.М. , Капаев В.В., Горбачев А.А. <i>Связанные состояния в непрерывном спектре и особые точки в многомодовых квантово-механических и оптических волноводах</i>	Шаров В.А. , Алексеев П.А., Можаров А.М., Федоров В.В., Мухин И.С. <i>Оптические свойства нитевидных нанокристаллов GaP при механической деформации</i>
10:10-10:25	Рыбин М.В. <i>Связанные фотонные состояния в континууме и суперрезонансные моды в диэлектрических структурах</i>	Никитин М.В. , Покровский В.Я., Зыбцев С.Г., Колесов В.В., Кашин В.В., Логинов Б.А. <i>Воздействие высокочастотных механических колебаний на транспортные свойства проводников(онлайн)</i>

10:25-10:50	(Пр.) Латышев А.В., Сидоров Г.Ю., Сидоров Ю.Г., Якушев М.В. <i>Матричные ИК-фотоприемники на основе гетероструктур узкозонных полупроводников (онлайн)</i>	(Пр.) Дурнев М.В. <i>Краевые токи в двумерных системах, индуцированные высокочастотным электрическим полем</i>
10:50-11:20	Coffee-break	
Заседание 11	А: Высококачественные явления – 2 Председатель В.М. Муравьев	Б: Атомарно-тонкие полупроводники – 2 Председатель М.М. Глазов
11:20-11:45	(Пр.) Кибис О.В. <i>Светоиндуцированное спаривание носителей заряда в квантовых ямах</i>	(Пр.) Торопов А.А. , Европейцев Е.А., Нечаев Д.В., Нестоклон М.О., Смирнов Д.С., Буренина Д.С., Гусева Ю.А., Задиранов Ю.М., Кулагина М.М., Жмерик В.Н., Шубина Т.В., Иванов С.В. <i>2D-экситоны в одиночных монослоях GaN в AlN</i>
11:45-12:00	Боев М.В. , Ковалев В.М., Иорш И.В., Кибис О.В. <i>Флоке-инженерия экситонов в полупроводниковых наноструктурах</i>	Ниязов Р.А. , Аристов Д.Н., Качоровский В.Ю. <i>Управляемые магнитным полем геликоидальные кристаллы</i>
12:00-12:15	Савченко М.Л. , Шуваев А., Дмитриев И.А., Ганичев С.Д., Квон З.Д., Пименов А. <i>Поляризационно-зависимые осцилляции магнитосопротивления, индуцированные микроволновым излучением (онлайн)</i>	Свинцов Д.А. , Капралов К.Н., Дмитриев И.А., Monch E., Linder K., Бандурин Д.А., Ганичев С. <i>Аномальный циклотронный резонанс в графене</i>
12:15-12:30	Андреев И.В. , Муравьев В.М., Семенов Н.Д., Кукушкин И.В. <i>Релятивистская перенормировка спектра магнитоплазмонов в двумерных электронных системах с сильным экранированием</i>	Бородин Б.Р. <i>Усиление фотолюминесценции в многослойных MoSe₂ наноструктурах, сформированных методом локального анодного окисления (онлайн)</i>

12:30-12:45	Дорохин М.В. , Дёмина П.Б., Ведь М.В., Хомицкий Д.В., Кабаев К.С., Balanta M.A.G., Iikawa F., Звонков Б.Н. <i>Эффект спиновой памяти в наноструктурах InGaAs/GaAs, дельта-легированных Mn</i>	Каламейцев А.В., Ковалёв В.М. <i>Поперечный акустоэлектрический эффект в графене</i>
12:45-13:00	Трухин В.Н. , Мустафин И.А., Соловьёв В.А., Чернов М.Ю., Сяни Фань <i>Терагерцовый эмиттер на основе эпитаксиального слоя InAs</i>	Клоков А.Ю. , Фролов Н.Ю., Шарков А.И., Николаев С.Н., Ченцов С.И., Чернопицкий М.А., Пугачев М.В., Дулесто А.И., Шуплецов А.В., Кривобок В.С., Кунцевич А.Ю. <i>Гиперзвуковая микроскопия ван-дер-ваальсовых гетероструктур на основе hBN/WSe₂/hBN/Al₂O₃</i>
13:00-13:15	Рожков А.В., Иванов М.С., Родин П.Б. <i>Коллапсирующие домены Ганна и lock-on-эффект в высоковольтных лавинных GaAs-диодах</i>	Алексеев П.С. , Алексеева А.П. <i>Фотосопротивление сильно вязкой электронной жидкости в магнитном поле: вязкоупругий резонанс и эффекты памяти</i>
13:15-13:30		Семина М.А. , Глазов М.М. <i>Трионы с отрицательной приведенной массой в двумерных полупроводниках</i>
13:45-14:00	Заккрытие конференции	
14:00-15:00	Обед	
	Отъезд участников	

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

3 октября, понедельник

1-я стендовая сессия

Гетероструктуры и сверхрешетки

1.	<u>Алтынбаев Л.А.</u> , Котова Л.В., Кочерешко В.П. <i>Естественная оптическая активность квантовых ям на основе CdTe с симметричными и асимметричными барьерами</i>
2.	<u>Резницкий А.Н.</u> , Агекян В.Ф., Будкин Г.В., Серов А.Ю., Философов Н.Г. <i>Спектроскопическое проявление туннельной связи в асимметричной системе двойных квантовых ям CdTe/ZnTe</i>
3.	<u>Гордеева А.Б.</u> , Маричев А.Е., Левин Р.В., Пушный Б.В., Шмидт Н.М., Гагис Г.С. <i>Спектроскопия анизотропного отражения как метод диагностики напряжений в гетероструктурах</i>
4.	Герчиков Л.Г., <u>Дашков А.С.</u> , Горай Л.И., Буравлёв А.Д. <i>ТГц-источники излучения на сверхрешётках AlGaAs/GaAs</i>
5.	Зайцев А.В., Молостова О.С., Самарцев И.В., Нежданов А.В., Байдусь Н.В., Левин А.А., Байдакова М.В., Сокура Л.А., Берт Н.А., Сресели О.М., <u>Ершов А.В.</u> <i>Люминесцентные свойства отожженных многослойных нанопериодических структур Ge/Al₂O₃ и Si/Ge/Si/Al₂O₃</i>
6.	<u>Каган М.С.</u> , Алтухов И.В., Дижур С.Е., Папроцкий С.К., Хвальковский Н.А., Ильинская Н.Д., Усикова А.А., Васильевский И.С., Виниченко А.Н., Баранов А.Н., Teissier R. <i>Электронный транспорт в сверхрешетках с электрическими доменами</i>
7.	<u>Литвинов Д.А.</u> , Кривобок В.С., Пашкеев Д.А., Клековкин А.В., Савин К.А., Минаев И.И., Николаев С.Н. <i>Получение и ближнепольная микроскопия квантовых точек InSb/GaSb</i>
8.	<u>Малин Т.В.</u> , Милахин Д.С., Мансуров В.Г., Вдовин В.И., Кожухов А.С. <i>Гетероструктуры AlGaIn/GaN, выращенные методом аммиачной МЛЭ на отечественных и зарубежных подложках Si(111)</i>
9.	<u>Михайлов И.А.</u> , Горячев А.В., Гришин Т.С., Поляков М.В., Волкова Л.С. <i>Исследование химического состава наногетероструктур Al_xGa_{1-x}As, полученных методом молекулярно-лучевой эпитаксии</i>
10.	<u>Николаев И.Д.</u> , Казаков А.С., Банников М.И., Меншиков Р.В., Михайлов Н.Н., Хохлов Д.Р., Иконников А.В. <i>Обратимая смена типа проводимости в двойных квантовых ямах HgTe/CdHgTe с помощью оптического затвора</i>

11.	Разова А.А., Кудрявцев К.Е., Румянцев В.В., Уточкин В.В., Алешкин В.Я., Михайлов Н.Н., Дворецкий С.А., Гавриленко В.И., Морозов С.В. <i>Температурное гашение стимулированного излучения гетероструктур с квантовыми ямами Hg(Cd)Te/CdHgTe в диапазоне длин волн 5–10 мкм</i>
12.	Ружевиц М.С., Семакова А.А., Баженов Н.Л., Мынбаев К.Д. <i>Оптические переходы в структурах на основе InAsSb</i>
13.	Самарцев И.В., Некоркин С.М., Звонков Б.Н., Чигинева А.Б., Чеченин Ю.И. <i>Метаморфные гетероструктуры для InP/GaAs СВЧ-диодов</i>
14.	Светогоров В.Н., Мармалюк А.А., Ладугин М.А., Рябоштан Ю.Л., Бахвалов К.В., Веселов Д.А., Лютецкий А.В., Стрелец В.А., Слипченко С.О., Пихтин Н.А. <i>Упругонапряженные гетероструктуры GaInAs/AlGaInAs/InP для мощных лазерных диодов спектрального диапазона 1.92–2.02 мкм</i>
15.	Тимофеев В.А., Машанов В.И., Никифоров А.И., Скворцов И.В., Лошкарев И.Д., Коляда Д.В., Фирсов Д.Д., Комков О.С. <i>Особенности формирования наноструктур GeSn и множественных квантовых ям GeSiSn/Si на наноструктурированной фасетированной поверхности (311)</i>
16.	Титова А.М., Шенгуров В.Г., Филатов Д.О., Веде М.В., Денисов С.А., Чалков В.Ю., Кузьмин М.Ю., Алябина Н.А., Здоровейцев А.В. <i>Выращенные методом HW CVD гетероэпитаксиальные n⁺-Ge/p⁺-Si(001) структуры для светоизлучающих диодов</i>
17.	Ушаков Д.В., Афоненко А.А., Хабибуллин Р.А., Васильевский И.С., Гавриленко В.И. <i>Многофотонные дизайны лазерных переходов в квантово-каскадных структурах ТГц-диапазона</i>
18.	Хазанова С.В., Бобров А.И., Горшков А.П., Сидоренко К.В., Малехонова Н.В., Байдусь Н.В. <i>Влияние электрического поля на вариацию показателя преломления InGaAs/AlGaAs/GaAs туннельно-связанных квантовых ям в модуляторе по схеме Маха – Цендера</i>

Полупроводниковые приборы и устройства

19.	Аношкин С.С., Пушкарев А.П., Макаров С.В. <i>Разработка синих перовскит-кадмиевых светодиодов</i>
20.	Желнин А.И., Багаев Т.А., Гультиков Н.В., Ладугин М.А., Мармалюк А.А., Курняк Ю.В., Кричевский В.В., Морозюк А.М., Коняев В.П., Симаков В.А., Слипченко С.О., Подоскин А.А., Пихтин Н.А. <i>Исследование излучательных характеристик гибридных и интегрированных импульсных лазеров-тиристоров</i>

21.	Богущ И.Ю., Плуготаренко Н.К. <i>Исследование характеристик электродов суперконденсаторов на основе кремний-углеродных структур</i>
22.	Бронников О.А., Гостищев П.А., Лучников Л.О., Саранин Д.С. <i>Нанокристаллический NiOx р-типа для перовскитной оптоэлектроники с применением лучевых технологий</i>
23.	Boudjemila L., Aleshin P.A., Malyshkin V.M., Scherbakov I.P., Petrov V.N., Belorus A.O., Kompan M.E., Terukov E.I., Aleshin A.N. <i>Electrical characteristics of CsPbI₃ and CsPbBr₃ lead halide perovskite nanocrystal films deposited on Si-C solar cells for high-efficiency photovoltaics</i>
24.	Войцеховский А.В., Несмелов С.Н., Дзядух С.М., Горн Д.И., Михайлов Н.Н., Дворецкий С.А., Меньшиков Р.В., Сидоров Г.Ю., Ужаков И.Н., Якушев М.В. <i>Электрофизические характеристики униполярных NBvN-структур на основе HgCdTe</i>
25.	Воробьев А.А., Шугуров К.Ю., Можаров А.М., Сапунов Г.А., Федоров В.В., Мухин И.С. <i>Диод Шоттки СВЧ-диапазона на одиночных нитевидных нанокристаллах нитрида галлия</i>
26.	Гостищев П.А., Саранин Д.С., Диденко С.И., Ди Карло А. <i>Анионное легирование галогенидных перовскитов для повышенной стабильности работы солнечных модулей</i>
27.	Гультиков Н.В., Ладугин М.А., Мармалюк А.А., Телегин К.Ю., Андреев А.Ю., Шестак Л.И., Панарин В.А. <i>Предельные мощностные характеристики линеек лазерных диодов (λ = 808 нм) на основе Al-содержащих и Al-free гетероструктур</i>
28.	
29.	Ерманова И.О., Ди Джакомо Ф., Саранин Д.С., Ди Карло А. <i>Пассивация интерфейса дырочно-транспортный слой/перовскит полимером для стабилизации работы солнечного элемента</i>
30.	Ерофеева И.В., Дорохин М.В., Кузнецов М.Ю., Демина П.Б., Здоровейцев А.В., Завражнов А.Ю., Воронин А.В. <i>Формирование наноструктурного SiGe, легированного фосфором, с термоэлектрическими свойствами</i>
31.	Залялов Т.М., Исламов Д.Р. <i>Влияние содержания примеси на сегнетоэлектрические свойства и концентрацию ловушек в Hf_{0.5}Zr_{0.5}O₂:La при циклировании</i>
32.	Золотарев В.В., Казакова А.Е., Слипченко С.О., Пихтин Н.А. <i>Разработка резонатора диодного лазера на основе двумерного фотонного кристалла с выводом излучения с поверхности чипа</i>

33.	<u>Золотарев В.В.</u> , Казакова А.Е., Ризаев А.Э., Слипченко С.О., Пихтин Н.А. <i>Увеличение апертуры излучения одномоновых полупроводниковых РБЗ-лазеров</i>
34.	<u>Иванов А.М.</u> , Клочков А.В. <i>Исследование электрофизических и шумовых характеристик светодиодов на основе InGaN/GaN квантовых ям при температуре жидкого азота</i>
35.	<u>Иштеев А.Р.</u> , Константинова К.М. <i>Исследование радиационной стойкости монокристаллов $MAPbBr_3$ и диодной структуры на их основе</i>
36.	<u>Калентьева И.Л.</u> , Вихрова О.В., Данилов Ю.А., Звонков Б.Н., Здорейцев А.В., Кудрин А.В. <i>Особенности технологии изготовления магниторезистивных диодов $p-(Ga,Mn)As/n-InGaAs/n^+-GaAs$</i>
37.	<u>Клоков А.Ю.</u> , Шарков А.И., Евлашин С.А., Хмельницкий Р.А. <i>Исследование тепловых свойств восстановленного лазерным излучением оксида графена методом lock-in ИК-радиометрии</i>
38.	<u>Протасов Д.Ю.</u> , Дмитриев Д.В., Журавлев К.С., Айзенштат Г.И., Ющенко А.Ю., Пашковский А.Б. <i>Оптимизация конструкции гетероструктур рНЕМТ для ключевых транзисторов СВЧ-диапазона</i>
39.	<u>Суханов М.А.</u> , Бакаров А.К., Журавлев К.С. <i>Молекулярно-лучевая эпитаксия и темновые токи InAlSb/InSb гетероструктур</i>
40.	<u>Бакаров А.К.</u> , Журавлев К.С., Пашковский А.Б., Богданов С.А., Лапин В.Г., Лукашин В.М. <i>DrНЕМТ миллиметрового диапазона с донорно-акцепторным легированием</i>
41.	<u>Комаричева Т.О.</u> , Талбанова Н.Р., Лучников Л.О., Саранин Д.С., Диденко С.И., Ди Карло А. <i>Зависимость выходной мощности перовскитных фотопреобразователей от цветовой температуры искусственных источников освещения</i>
42.	<u>Ле Тхай Шоң</u> , Гостищев П.А., Саранин Д.С., Диденко С.И., Альдо Ди Карло. <i>Slot-die печатные перовскитные солнечные элементы и мини-модули</i>
43.	<u>Блохин С.А.</u> , Бабичев А.В., Гладышев А.Г., Бобров М.А., Карачинский Л.Я., Новиков И.И., <u>Малеев Н.А.</u> , Воропаев К.О., Егоров А.Ю., Li H., Tian S.C., Nan S.Y., Vimberg D. <i>Высокоскоростные вертикально-излучающие лазеры спектрального диапазона 1300–1550 нм</i>
44.	<u>Ненашев Г.В.</u> , Алешин А.Н. <i>Влияние температуры на свойства двухтерминального металлоорганического перовскитного перезаписываемого мемристора для нейроморфных операций</i>

45.	<u>Шенгуров Д.В.</u> , Скороходов Е.В., Гусев С.А., Юрасов Д.В., Шалеев М.В., <u>Новиков А.В.</u> <i>Плазмохимическое травление Si и Ge на большую глубину с использованием маски из электронных резистов</i>
46.	<u>Оболенский С.В.</u> , Хазанова С.В., Голиков О.Л., Пузанов А.С., Тарасова Е.А., Забавичев И.Ю., Потехин А.А., Оболенская Е.С., Иванов А.С., Павельев Д.Г. <i>Моделирование вольт-амперных характеристик и пробоя в сверхрешетках с малым числом периодов</i>
47.	<u>Подоскин А.А.</u> , Головин В.С., Шушканов И.В., Веселов Д.А., Николаев Д.Н., Пихтин Н.А., Копьев П.С., Слипченко С.О. <i>Импульсные суб-нс источники лазерного излучения на основе GaAs/AlGaAs лазерных гетероструктур с объёмной активной областью</i>
48.	<u>Подоскин А.А.</u> , Золотарев В.В., Слипченко С.О., Романович Д.Н., Соболева О.С., Стрелец В.А., Капитонов В.А., Бахвалов К.В., Казакова А.Е., Фомин Е., Пихтин Н.А. <i>Модовая селекция во внешнем резонаторе для линеек одномоновых лазеров на длину волны 1060 нм</i>
49.	<u>Слипченко С.О.</u> , Подоскин А.А., Шашкин И.С., Веселов Д.А., Николаев Д.Н., Пихтин Н.А., Копьев П.С. <i>Оптическая связь в линейках латеральных одномоновых волноводов и ее влияние на динамику модовой структуры лазерных источников (1060 нм) на их основе</i>
50.	<u>Соболева О.С.</u> , Головин В.С., Слипченко С.О., Пихтин Н.А. <i>Сравнительный анализ излучательных характеристик мощных полупроводниковых лазеров (1060 нм) в рамках стационарных 1D и 2D моделей с учетом транспорта носителей</i>
51.	<u>Стрельчук А.М.</u> <i>Характерные особенности токов в идеальных и неидеальных диодах на основе карбида кремния</i>
52.	<u>Тумашев В.С.</u> , Селезнев В.А. <i>Влияние геометрии Au-катализатора на формирование упорядоченных массивов наностолбиков при металл-стимулированном каталитическом травлении кремния</i>
53.	<u>Чигинева А.Б.</u> , Байдусь Н.В., Жидяев К.С., Некоркин С.М., Самарцев И.В. <i>Тиристорные A_3B_5-структуры, выращенные методом ГФЭ МОС, и приборы на их основе</i>
54.	<u>Шайблер Г.Э.</u> , Косолобов С.Н., Терехов А.С., Jones L.B., Militsyn V.L., Noakes T.C.Q. <i>Немонотонное поведение средней поперечной энергии электронов, эмитированных р-GaAs(Cs,O) фотокатодом, в процессе его кислород-индуцированной деградации</i>

55.	<u>Шарафутдинова А.М.</u> , Мартышов М.Н., Павликов А.В., Константинова Е.А. <i>Электрофизические свойства нанотрубок диоксида титана, модифицированных медью</i>
56.	Павликов А.В., <u>Шарафутдинова А.М.</u> , Гаврилин И.М., Зайцев В.Б., Дронов А.А., Гаврилов С.А. <i>Влияние термической обработки на структурные и оптические свойства нанонитей Ge, полученных электрохимическим осаждением</i>
57.	Володин В.А., <u>Юшков И.Д.</u> , Liping Yin, Камаев Г.Д., Vergnat M. <i>Мемристоры на основе слоёв GeSi_xO_y с нанокластерами германия</i>
58.	<u>Якубов А.О.</u> , Терехов Д.Ю., Пепеляев Д.В., Савицкий А.И., Мурашко Д.Т., Ступин А.А. <i>Исследования адгезии тонких пленок Ge₂Sb₂Te₅ к гибкой подложке</i>
59.	<u>Якубов А.О.</u> , Савицкий А.И., Кузовков Д.О., Лазаренко П.И. <i>Температурные зависимости электрофизических характеристик тонких пленок Ge₂Sb₂Te₅</i>

4 октября, вторник

2-я стендовая сессия

Поверхность, пленки, слои

1.	<u>Петрушков М.О.</u> , Абрамкин Д.С., Путятю М.А., Емельянов Е.А., Васев А.В., Гутаковский А.К., Преображенский В.В. <i>Искусственные подложки GaAs/Si(001), выращенные методом МЛЭ с использованием слоёв LT-GaAs</i>
2.	<u>Аксенов М.С.</u> , Гензе И.Ю., Чистохин И.Б., Дмитриев Д.В., Гутаковский А.К. <i>Влияние отжига на электрофизические и физико-химические свойства Ti/InAlAs и Pt/InAlAs контактов Шоттки</i>
3.	<u>Аксенов М.С.</u> , Ковчавцев А.П., Горшков Д.В. <i>Влияние фтора на электронные свойства границ раздела диэлектрик(оксид)/InGaAs</i>
4.	<u>Алексеев П.А.</u> , Бородин Б.Р., Шаров В.А., Смирнов А.Н. <i>Закрепление уровня Ферми на окисленной поверхности A^{III}B^V-наноструктур</i>
5.	<u>Бакин В.В.</u> , Косолобов С.Н., Рожков С.А., Шайблер Г.Э., Терехов А.С. <i>Преломление электронов на интерфейсе «p-GaAs(Cs, O) – вакуум»</i>
6.	Волкова Л.С., Гришин Т.С., Поляков М.В., Михайлов И.А., Новиков Д.В. <i>Получение и исследование свойств плазмонных слоев на основе наноструктур TiO_x</i>
7.	Васильев В.И., <u>Гагис Г.С.</u> , Бер Б.Я., Казанцев Д.Ю., Токарев М.В., Кучинский В.И., Нахимович М.В., Хвостиков В.П. <i>Получение наноразмерных слоёв твёрдых растворов в пластинах GaSb, GaAs, InAs за счёт твердофазных реакций замещения</i>

8.	Новиков Ю.Н., <u>Гисматулин А.А.</u> , Гриценко В.А., Ройзин Я.О. <i>Транспорт заряда в пленках аморфного оксида алюминия, изготовленных в промышленной ALD-установке, с учетом контактов с различными материалами</i>
9.	<u>Горшков Д.В.</u> , Закиров Е.Р., Сидоров Г.Ю., Сабина И.В., Марин Д.В. <i>Исследование границы раздела между CdHgTe и HfO₂, выращенным методом плазменно-индуцированного атомно-слоевого осаждения</i>
10.	<u>Закиров Е.Р.</u> , Кеслер В.Г., Сидоров Г.Ю., Сабина И.В., Голяшов В.А., Терещенко О.Е. <i>Предварительная химическая очистка CdHgTe от естественного оксида в растворах соляной кислоты и аммиака</i>
11.	<u>Гришин Т.С.</u> , Волкова Л.С., Михайлов И.А., Поляков М.В., Новиков Д.В. <i>Исследование формирования наночастиц серебра на поверхности SiO₂, полученных вакуумными методами напыления</i>
12.	<u>Данилов Ю.А.</u> , Вихрова О.В., Дроздов М.Н., Лесников В.П., Крюков Р.Н., Нежданов А.В., Ковальский В.А., Сриянанда Р.А.С.А. <i>Свойства слоев углерода, полученных импульсным лазерным методом</i>
13.	<u>Зиновьев В.А.</u> , Зиновьева А.Ф., Крупин А.Ю., Володин В.А., Двуреченский А.В. <i>Двумерные слои Si, полученные методом молекулярно-лучевой эпитаксии на подложках CaF₂/Si(111)</i>
14.	Емельянов Е.А., Петрушков М.О., Гаврилова Т.А., Путятю М.А., Васев А.В., Семягин Б.Р., <u>Преображенский В.В.</u> <i>Влияние толщины маски на основе эпитаксиальных слоев Si/GaAs(001) на самокаталитический рост нитевидных нанокристаллов A^{III}B^V</i>
15.	<u>Петрушков М.О.</u> , Емельянов Е.А., Чистохин И.Б., Путятю М.А., Преображенский В.В., Гаврилова Т.А., Протасов Д.Ю., Камеш П.П. <i>Диффузия Zn в InP из планарного источника Zn₃P₂ при быстром термическом отжиге</i>
16.	<u>Емельянов Е.А.</u> , Путятю М.А., Петрушков М.О., Преображенский В.В., Семягин Б.Р., Васев А.В., Лошкарев И.Д., Василенко А.П. <i>Молекулярно-лучевая эпитаксия твердого раствора GaP_xAs_{1-x} на вицинальной поверхности (001): кинетическая модель формирования состава в анионной подрешетке</i>
17.	<u>Кацуба А.В.</u> , Двуреченский А.В., Камаев Г.Н., Володин В.А. <i>Радиационное зарождение и рост кристаллов CaSi₂ в процессе эпитаксиального роста CaF₂ и после формирования пленки CaF₂</i>
18.	<u>Клочков А.Н.</u> , Виниченко А.Н., Самольга А.А., Сафонов Д.А., Смирнова М.О., Рындя С.М., Тимофеев А.А., Васильевский И.С. <i>Эпитаксиальный рост пленок n-InAs на подложках из сапфира</i>
19.	<u>Дмитриев Д.В.</u> , Колосовский Д.А., Торопов А.И., Журавлев К.С. <i>Трансформация поверхности InP(001) при удалении оксида в потоке мышьяка</i>

20.	Бессолов В.Н., <u>Коненкова Е.В.</u> , Родин С.Н., Соломникова А.В. <i>Эпитаксия полупроводниковых слоев GaN на наноструктурированных Si-подложках</i>
21.	<u>Королев Д.С.</u> , Никольская А.А., Матюнина К.С., Михайлов А.Н., Белов А.И., Нежданов А.В., Крюков Р.Н., Сушков А.А., Павлов Д.А., Юнин П.А., Тетельбаум Д.И. <i>Исследование процессов ионно-лучевого формирования нановключений оксида галлия в диэлектрических матрицах</i>
22.	<u>Краснова И.А.</u> , Горшков Д.В., Сидоров Г.Ю., Сабина И.В., Марин Д.В. <i>Исследование пассивирующих свойств собственного оксида CdHgTe для поверхности, подвергнутой жидкостному травлению</i>
23.	<u>Лозовой К.А.</u> , Дирко В.В., Коханенко А.П., Войцеховский А.В. <i>Анализ сверхструктурных переходов при низкотемпературном росте наноструктур в системе Ge/Si</i>
24.	<u>Милахин Д.С.</u> , Малин Т.В., Мансуров В.Г., Башкатов Д.Д., Журавлев К.С. <i>Начальная стадия эпитаксии нитрида алюминия на поверхности Si(111) с разной степенью нитридации</i>
25.	<u>Башкатов Д.Д.</u> , Милахин Д.С., Малин Т.В., Вдовин В.И., Журавлев К.С. <i>Подготовка поверхности кремния Si(111) к эпитаксиальному росту структур A₃-нитридов методом МЛЭ</i>
26.	<u>Майдэбура Я.Е.</u> , Малин Т.В., Журавлев К.С. <i>Преобразование морфологии и поверхностной энергии монослоев GaN, выращенных на поверхности AlN, при циклировании потока аммиака</i>
27.	<u>Настовьяк А.Г.</u> , Шварц Н.Л. <i>Моделирование капельной эпитаксии нанокластеров GaN</i>
28.	<u>Прокопьев А.Р.</u> , <u>Неустроев Е.П.</u> <i>Исследование свойств углеродных пленок, сформированных методом осаждения в низкотемпературной плазме метана и лазерного облучения</i>
29.	<u>Поляков М.В.</u> , Горячев А.В., Гришин Т.С., Михайлов И.А., Волкова Л.С. <i>Исследование термической стабильности наноструктурированного CoCrFeNiCu высокоэнтропийного сплава</i>
30.	<u>Пономарев С.А.</u> , <u>Рогило Д.И.</u> , Миронов А.Ю., Курус Н.Н., Милехин А.Г., Щеглов Д.В., Латышев А.В. <i>Низкотемпературный гистерезис фазового перехода $\beta \leftrightarrow \beta'$ в пленках In₂Se₃/Si(111)</i>
31.	<u>Пономарев С.А.</u> , <u>Рогило Д.И.</u> , Курус Н.Н., Басалаева Л.С., Кох К.А., Милехин А.Г., Щеглов Д.В., Латышев А.В. <i>In situ отражательная электронная микроскопия для изучения процессов на поверхности Bi₂Se₃(0001)</i>

32.	<u>Рогило Д.И.</u> , Ситников С.В., Пономарев С.А., Щеглов Д.В., Федина Л.И., Латышев А.В. <i>Структурные и морфологические нестабильности Si(111)-7×7 в процессе роста кремния и травления кислородом и селеном</i>
33.	<u>Рожков С.А.</u> , Бакин В.В., Косолобов С.Н., Шайблер Г.Э., Терехов А.С. <i>Термодинамическая стабильность фотоэмиссионных свойств p-GaAs(Cs,O) фотокатода</i>
34.	<u>Рудин С.А.</u> , Зиновьев В.А., Смагина Ж.В., Новиков П.Л., Ненашев А.В., Павский К.В., Двуреченский А.В. <i>Зарождение и рост квантовых точек Ge на структурированных подложках Si</i>
35.	<u>Спирина А.А.</u> , Шварц Н.Л. <i>Влияние ориентации и морфологии подложек на направление роста GaAs-нанопроволок</i>
36.	<u>Арапкина Л.В.</u> , <u>Чиж К.В.</u> , <u>Сторожевых М.С.</u> , Дубков В.П., Юрьев В.А. <i>Влияние рельефа поверхности Si/Si(001) на структуру смачивающих слоев Ge</i>
37.	<u>Арапкина Л.В.</u> , <u>Чиж К.В.</u> , <u>Ставровский Д.Б.</u> , Дубков В.П., <u>Сторожевых М.С.</u> , Клименко А.А., Дудин А.А., Юрьев В.А. <i>Диффузия атомов водорода в слоях Si и Ge, выращенных на диэлектрических подложках</i>
38.	<u>Федина С.В.</u> , Федоров В.В. <i>Особенности процессов формирования эпитаксиальных массивов самокаталитических GaP ННК на Si(111)</i>
39.	<u>Хахулин С.А.</u> , Фирсов Д.Д., Комков О.С. <i>Реализация метода спектроскопии анизотропного отражения в среднем инфракрасном диапазоне</i>
40.	<u>Хорошилов В.С.</u> , Протопопов Д.Е., Казанцев Д.М., <u>Шайблер Г.Э.</u> , Альперович В.Л. <i>Особенности спектров квантового выхода фотоэмиссии из p-GaAs(Cs,O), обусловленные пленением излучения в эпитаксиальной структуре</i>
41.	<u>Швец В.А.</u> , Азаров И.А., Марин Д.В., Якушев М.В., Рыхлицкий С.В. <i>Эллипсометрическая термометрия в низкотемпературных процессах роста гетероструктур на основе кадмий-ртуть-теллура</i>

Примеси и дефекты

42.	<u>Александров И.А.</u> , Дмитриев Д.В., Гаврилова Т.А., Журавлев К.С.
-----	--

	<i>Процессы диффузии атомов As в InP</i>
43.	<u>Барышников К.А.</u> , Крайнов И.В. <i>Микроскопический расчет константы обменного взаимодействия дырки и d-оболочки примесного марганца в объемном GaAs</i>
44.	<u>Белов П.А.</u> <i>Ширины уровней и энергетические сдвиги резонансных примесных состояний электрона в квантовых ямах с бесконечными барьерами</i>
45.	<u>Вихрова О.В.</u> , Данилов Ю.А., Здравейцев Д.А., Калентьева И.Л., Кудрин А.В., Лесников В.П., Нежданов А.В., Парафин А.Е. <i>Комбинированный лазерный метод получения магнитных полупроводников</i>
46.	Михайлова А.М., Ревин А.А., <u>Конаков А.А.</u> , Цыпленков В.В., Шастин В.Н. <i>Электронные состояния двухзарядных доноров в непрямозонных полупроводниках</i>
47.	Гладилин А.А., Миронов С.А., Уваров О.В., <u>Калинушкин В.П.</u> , Студеникин М.И., Гаврищук Е.М., Тимофеева Н.А. <i>Влияние различных режимов легирования железом на состав и пространственное распределение примесно-дефектных центров в CVD-ZnSe</i>
48.	<u>Приходько Д.Д.</u> , Болдырев К.Н., Денисов В.Н., Тарелкин С.А., Галкин А.С., Кузнецов М.С., Носухин С.А., Маврин Б.Н., Суханов А.А., Терентьев С.А., Бланк В.Д. <i>Электронные состояния донорного центра в алмазе, образованного атомом фосфора в позиции замещения</i>
49.	<u>Сарычев М.Н.</u> , Жевстовских И.В., Коростелин Ю.В., Суриков В.Т., Аверкиев Н.С., Гудков В.В. <i>Ультразвуковые исследования ян-теллеровских комплексов в кристалле CdSe:Cr</i>
50.	<u>Сибатов Р.Т.</u> , Кицюк Е.П., Шаман Ю.П. <i>Модель прыжкового транспорта в нанокompозитах органический полупроводник – углеродные нанотрубки</i>
51.	<u>Скоморохов А.М.</u> , Вейшторт И.П., Анисимов А.Н. <i>Объединённое исследование алмазных пластин для определения концентраций NV-дефектов</i>
52.	<u>Трушин О.С.</u> <i>Альтернативные механизмы релаксации упругих напряжений в гетеро-эпитаксиальной структуре Ge/Si(001)</i>
53.	<u>Цыпленков В.В.</u> , Шастин В.Н. <i>Фотонное эхо на внутрицентровых переходах мелких доноров в Ge</i>
54.	<u>Ченцов С.И.</u> , Кривобок В.С., Николаев С.Н., Аминев Д.Ф., Онищенко Е.Е., Клоков А.Ю. <i>Лазерное воздействие на одиночные люминесцентные центры,</i>

	<i>сформированные ядрами частичных дислокаций в CdTe</i>
Нано- и оптомеканика	
55.	<u>Вяткин Е.С.</u> , Поддубный А.Н. <i>Теория оптомеканического разогрева и охлаждения фононов в поляритонных микрорезонаторах</i>
56.	<u>Дунаевский М.С.</u> , Алексеев П.А., Шаров В.А. <i>Генерация тока при трении контакта металл-полупроводник</i>

5 октября, среда

3-я стендовая сессия

Объемные полупроводники

1.	<u>Бадалова З.И.</u> , Велиев Р.Г., Джахангирли З.А., Ализаде Е.Х., Федотова Ю.А., Абдуллаев Н.А. <i>Электронные и фононные спектры магнитных полупроводниковых соединений TlFeS₂ и TlFeSe₂</i>
2.	<u>Бобин С.Б.</u> , Лончаков А.Т. <i>Положительная продольная магнитопроводимость селенида ртути, вызванная киральным магнитным эффектом</i>
3.	Абилов Ч.И., Гасанова М.Ш., Касумова Э.К., Гусейнова Н.Т. <i>Некоторые оптические свойства тонкопленочных структур</i>
4.	<u>Дементьев П.А.</u> , Дементьева Е.В., Дунаевский М.С., Шакирова А.А., Кремлева А.В., Панов Д.Ю., Спиридонов В.А., Романов А.Е., Бугров В.Е., Заморянская М.В. <i>Эволюция электрофизических свойств объемных кристаллов β-(Ga_xAl_{1-x})₂O₃</i>
5.	<u>Дементьева Е.В.</u> , Дементьев П.А., Яговкина М.А., Кремлева А.В., Панов Д.Ю., Спиридонов В.А., Романов А.Е., Бугров В.Е., Заморянская М.В. <i>Особенности люминесценции объемных кристаллов β-(Ga_xAl_{1-x})₂O₃</i>
6.	Дорохин М.В., Веде М.В., <u>Дикарева Н.В.</u> , Демина П.Б., Здравейцев Д.А., Болдин М.С., Воронин А.В. <i>Люминесценция наноструктурированного кремния</i>
7.	<u>Зорина М.В.</u> , Михайленко М.С., Пестов А.Е., Чернышев А.К., Кузнецов И.И. <i>Черный кремний, полученный методом ионно-пучкового травления</i>
8.	<u>Кадинская С.А.</u> , Кондратьев В.М., Киндюшов И.К., Кузнецов А., Лихачев А.И., Нашекин А.В., Большаков А.Д. <i>Исследование фотоэлектрических свойств гидротермальных наноструктур оксида цинка</i>

9.	<u>Калинников М.А.</u> , Лобанов Д.Н., Андреев Б.А., Кудрявцев К.Е., Юнин П.А., Скороходов Е.В., Новиков А.В., Красильник З.Ф. <i>Формирование эпитаксиальных слоев InGaN для источников видимого красного и ИК-диапазонов методом ПА МПЭ</i>
10.	<u>Козлов Д.В.</u> , Жолудев М.С., Румянцев В.В., Иконников А.В., Pavlov S., Hubers H.-W., Морозов С.В. <i>Температурная зависимость уровня Ферми в узкозонных объемных пленках HgCdTe при различной концентрации вакансий ртути</i>
11.	<u>Коробейников И.В.</u> , Морозова Н.В., Миядзима Н., Овсянников С.В. <i>Повышение термоэлектрического фактора мощности в кристаллах p-SnSe при высоком давлении</i>
12.	<u>Коробейников И.В.</u> , Морозова Н.В., Овсянников С.В. <i>Термоэлектрические свойства орторомбической фазы высокого давления теллурида олова</i>
13.	<u>Кузнецов Ю.М.</u> , Дорохин М.В., Дёмина П.Б., Ерофеева И.В., Здоровейщев А.В., Завражнов А.Ю., Ведь М.В., Воронин А.В. <i>Термоэлектрические свойства Ge_xSi_{1-x} легированного из источника фосфида кремния</i>
14.	<u>Лончаков А.Т.</u> , Старостин А.А., Шангин В.В., Бобин С.Б., Котов А.Н. <i>Исследование приповерхностной области монокристаллических образцов HgSe комбинированным методом терморелефтометрии и интерферометра Фабри – Перо</i>
15.	<u>Мамедова И.А.</u> , Джахангирли З.А., Ализаде Э.Г., Керимова Т.Г., Мамедов Н.Т., Абдуллаев Н.А. <i>Расчёты из первопринципов и экспериментальное исследование методом спектральной эллипсометрии электронных свойств монокристаллов $CdGa_2Se_4$</i>
16.	<u>Никольская А.А.</u> , Королев Д.С., Михайлов А.А., Белов А.И., Конаков А.А., Сушков А.А., Павлов Д.А., Тетельбаум Д.И. <i>Ионно-лучевой синтез гексагонального кремния фазы 9R-Si на подложках Si с разной ориентацией</i>
17.	<u>Романова О.Б.</u> , Аплеснин С.С., Ситников М.Н., Удод Л.В. <i>Электронный фазовый переход в системе $Ho_xMn_{1-x}S$</i>
18.	<u>Семенова Л.Е.</u> <i>Резонансное рассеяние света на ТО-фононах при двухфотонном возбуждении в кристалле CdS</i>
19.	<u>Ситников М.Н.</u> , Харьков А.М., Никитинский О.С., Черемных Н.А. <i>Релаксационные эффекты и ток в $Li_xMn_{1-x}S$, индуцируемый ультразвуком</i>
20.	<u>Сторожевых М.С.</u> , Калинушкин В.П., Уваров О.В., Чегнов В.П., Чегнова О.И., Юрьев В.А. <i>Временные зависимости фотопроводимости в кристаллах ZnSe:Te, легированных железом</i>
21.	<u>Буга С.Г.</u> , <u>Тарелкин С.А.</u> , Кузнецов М.С., Лупарев Н.В.,

	<u>Приходько Д.Д.</u> , Терентьев С.А., Бланк В.Д. <i>Транспортные свойства синтетических монокристаллов алмаза, легированных азотом в диапазоне $T = 450-1000$ К</i>
22.	<u>Никольская А.А.</u> , Королев Д.С., Белов А.И., Михайлов А.А., Трушин В.Н., Павлов Д.А., Питиримова Е.А., Кудрин А.В., Дроздов М.Н., Николичев Д.Е., Крюков Р.Н., Тетельбаум Д.И. <i>Свойства слоев монокристаллов $\beta-Ga_2O_3$, подвергнутых имплантации ионов кремния</i>
23.	<u>Тихомирова Г.В.</u> , Петросян Т.К., Волкова Я.Ю., Тебеньков А.В., Соколовский Д.Н. <i>Фазовые переходы в углеродных материалах при высоких давлениях</i>
24.	<u>Удод Л.В.</u> , Аплеснин С.С., Ситников М.Н., Романова О.Б. <i>Влияние замещения ионами железа на фазовые переходы в пирофанате висмута методом ИК-спектроскопии</i>
25.	<u>Харьков А.М.</u> , Ситников М.Н., Рунов Р.В., Ситников Р.А. <i>Магнитоимпеданс в полупроводниках $Ho_xMn_{1-x}S$</i>
26.	<u>Шестаков А.В.</u> , Фазлижанов И.И., Уланов В.А. <i>Зависимость формы линий спектров ЭПР узкозонных полупроводников $Pb_{1-x}Gd_xTe$ ($x = 0.001$) от микроволновой мощности</i>

Спиновые явления

27.	<u>Анисимов А.Н.</u> , Бреев И.Д. <i>Расщепление спинов вакансионных центров в гексагональном SiC от механического напряжения</i>
28.	<u>Аплеснин С.С.</u> , Кретинин В.В., Абдельбаки Х., Романова О.Б., Никитинский О.С. <i>Магнитосопротивление на постоянном и переменном токе в феррите висмута с кобальтом</i>
29.	<u>Ведь М.В.</u> , Дорохин М.В., Здоровейщев А.В., Дёмина П.Б., Здоровейщев Д.А., Дудин Ю.А., Котомина В.Е. <i>Спиновый светодиод с модуляцией интенсивности</i>
30.	<u>Вейшторг И.П.</u> , Скоморохов А.М., Анисимов А.Н. <i>ОДМР в изотопно-модифицированном карбиде кремния</i>
31.	<u>Глазов М.М.</u> , Голуб Л.Е. <i>Спиновый эффект Холла в сверхчистых электронных каналах</i>
32.	<u>Головатенко А.А.</u> , Семина М.А., Родина А.В. <i>Фактор Ланде и ларморова прецессия дырки в полупроводниковых нанокристаллах</i>
33.	<u>Здоровейщев А.В.</u> , Дёмина П.Б., Дорохин М.В., Данилов Ю.А., Дудин Ю.А., Калентьева И.Л. <i>Управление характеристиками спиновых светоизлучающих диодов</i>

	<i>InGaAs/GaAs/Al₂O₃/CoPt</i> ионным облучением
34.	<u>Козлов И.И.</u> , Козырев Н.В., Намозов Б.Р., Кусраев Ю.Г. <i>Двойной резонанс в рамановском рассеянии света с испусканием оптического фона в квантовых ямах (Cd, Mn)Te</i>
35.	<u>Козырев Н.В.</u> , Ахмадуллин Р.Р., Намозов Б.Р., Кусраев Ю.Г. <i>Энергетическая и спиновая релаксация экситонов и трионов в квантовых ямах (Cd, Mn)Te</i>
36.	<u>Лихачев К.В.</u> , Бреев И.Д., Нагалюк С.С., Анкудинов А.В., Анисимов А.Н. <i>Изготовление и исследование квантовых сенсоров, совмещенных с атомно-силовым микроскопом, на основе вакансионных центров наночастиц 6H-SiC</i>
37.	<u>Лукоянов А.В.</u> , Байдак С.Т., Князев Ю.В. <i>Зонная структура и топологические особенности соединений Gd(Ni)Sb</i>
38.	<u>Ляпилин И.И.</u> <i>Новый метод генерации спинового тока в гибридных структурах</i>
39.	<u>Рагоза М.Д.</u> , Козырев Н.В., Намозов Б.Р., Некрасов С.В., Кусраев Ю.Г. <i>Эффект магнитосопротивления при поляризованной подсветке в эпитаксиальных пленках GaAs n-типа</i>
40.	<u>Чернопицкий М.А.</u> , Николаев С.Н. <i>Комбинационное рассеяние света с переворотом спина в объемных кристаллах GaSe</i>
41.	<u>Шредер Е.И.</u> , Чернов Е.Д., Лукоянов А.В., Марченков В.В. <i>Электронная структура и оптические свойства сплавов Гейслера Mn₂MeAl (Me=Ti, V, Cr) с высокой спиновой поляризацией</i>
42.	Kirstein E., Коптева Н.Е., Яковлев Д.Р., Жуков Е.А., Колобкова Е.В., Кузнецова М.С., Белых В.В., <u>Югова И.А.</u> , Глазов М.М., Bayer M.B., Greilich A. <i>Синхронизация спиновой прецессии дырок в перовскитных нанокристаллах CsPb(Cl,Br)₃</i>

Атомарно-тонкие полупроводники

43.	<u>Архипова Е.А.</u> , Дроздов М.Н., Охапкин А.И., Краев С.А., Хрыкин О.И., Богданов С.А., Вихарев А.Л., Исаев В.А., Лобаев М.А. <i>Транспортные свойства дельта-слоев бора в CVD-алмазе</i>
44.	<u>Бородин Б.Р.</u> <i>Фрикционная механическая зондовая литография дихалькогенидов переходных металлов</i>
45.	<u>Глазов М.М.</u> <i>Влияние деформации на тонкую структуру экситонных состояний в монослоях дихалькогенидов переходных металлов</i>

46.	<u>Кривоногова А.Ю.</u> , Курусь Н.Н., Милёхин И.А., Колосветов А.А., Милёхин А.Г. <i>Оптические свойства двумерных островков дисульфида вольфрама (WS₂)</i>
47.	<u>Курусь Н.Н.</u> , Милёхин И.А., Небогатикова Н.А., Антонова И.В., Родякина Е.Е., Милёхин А.Г., Латышев А.В. <i>НаноКРС графеном в режиме целевого плазмона</i>
48.	<u>Мансуров В.Г.</u> , Тийс С.А., Малин Т.В., Милахин Д.С., Журавлев К.С. <i>Фурье-анализ СТМ-изображений при формировании g-Si₃N₃ на начальных этапах нитридации поверхности кремния Si(111)</i>
49.	<u>Николаев С.Н.</u> , Екимов Е.А., Сидоров В.А., Деева А.А., Ширяев А.А., Чернопицкий М.А., Кривобок В.С. <i>Новая слоистая фаза EuS₂</i>
50.	<u>Сарычев М.Н.</u> , Жевстовских И.В., Семенова О.И. <i>Экситонные состояния в монокристаллах перовскита CH₃NH₃PbBr₃</i>
51.	Бодров С.Б., Корытин А.И., <u>Сергеев Ю.А.</u> , Степанов А.Н. <i>Нелинейное прохождение ТГц-излучения через графен</i>
52.	<u>Сибатов Р.Т.</u> , Мефтахутдинов Р.М., Кочаев А.И. <i>Асимметричные монослои XMoSiN₂ (X=S, Se, Te) и вертикальные гетероструктуры на их основе для применений в наноэлектронике</i>
53.	Бричкин А.С., Голышков Г.М., <u>Черненко А.В.</u> <i>Зависимость ширины линий фотолюминесценции структур с монослоями дихалькогенидов переходных металлов от толщины инкапсулирующего слоя нитрида бора</i>

Высокочастотные явления в полупроводниках

54.	Hasanov E.R., <u>Khalilova Sh.G.</u> , Mammadova G.M., Alakbarov A.I. <i>The frequency of current fluctuations in two-valley semiconductors in an external electric and strong magnetic ($\mu H > c$) fields</i>
55.	<u>Андреев И.В.</u> , Муравьев В.М., Семенов Н.Д., Гусихин П.А., Кукушкин И.В. <i>Поперечные плазменные волны в двумерной электронной системе с задним затвором</i>
56.	<u>Белов Д.А.</u> , Иконников А.В., Пушкарев С.С., Галиев Р.Р., Пономарев Д.С., Хохлов Д.Р., Ушаков Д.В., Афоненко А.А., Морозов С.В., Гавриленко В.И., Хабибуллин Р.А. <i>Температурные зависимости мощностных характеристик квантово-каскадных лазеров терагерцевого диапазона</i>
57.	<u>Бельков В.В.</u> , Качоровский В.Ю., Голуб Л.Е., Поташин С.О., Горбенко И.В., Ганичев С.Д. <i>Фототоки в графеновых латеральных сверхрешетках</i>

58.	<u>Ткаченко В.А.</u> , Ярошевич А.С., Кузьмин Н.С., Квон З.Д., Бакаров А.К., Ткаченко О.А., Родякина Е.Е., Латышев А.В. <i>СВЧ-фотоконтактанс структур с квантовым точечным контактом</i>
59.	<u>Ковалёв В.М.</u> , Боев М.В., Парафило А.В., Савенко И.Г. <i>Линейный фотогальванический эффект в монослоях дихалькогенидов переходных металлов в полупроводниковом и сверхпроводящем режимах</i>
60.	<u>Можаров А.М.</u> , Шугуров К.Ю., Сапунов Г.А., Федоров В.В., Мухин И.С. <i>Теоретическое и экспериментальное исследование работы диода Ганна на основе нитевидных нанокристаллов нитрида галлия</i>
61.	<u>Ормонт М.А.</u> , Ляшенко А.А. <i>Влияние кулоновских эффектов на частотную зависимость проводимости неупорядоченных полупроводников</i>
62.	<u>Ормонт М.А.</u> <i>Особенности использования степенной функции при анализе частотных зависимостей проводимости неупорядоченных полупроводников</i>
63.	<u>Семенов Н.Д.</u> , Муравьев В.М., Андреев И.В., Кукушкин И.В. <i>Применение метода LC-контуров для проектирования плазмонного резонатора</i>

6 октября, четверг

4-я стендовая сессия

Нульмерные системы

1.	<u>Абрамкин Д.С.</u> , Петрушков М.О., Богомолов Д.Б., Емельянов Е.А., Есин М.Ю., Путято М.А., Преображенский В.В. <i>Новые GaSb/AlP квантовые точки – перспективный объект для создания универсальной памяти</i>
2.	<u>Авдеев И.Д.</u> , Нестоклон М.О., Гупалов С.В. <i>Перенормировка g-факторов в квантовых точках из халькогенида свинца</i>
3.	<u>Басалаева Л.С.</u> , Дуда Т.С., Курусь Н.Н., Графова В.П., Васильев Р.Б., Милёхин А.Г. <i>Исследование фононного спектра коллоидных двумерных наноструктур ZnSe</i>
4.	<u>Бурдов В.А.</u> <i>Резонансный перенос экситонов в ансамблях нанокристаллов: универсальность фёрстеровского подхода</i>
5.	<u>Головатенко А.А.</u> , Рахлин М.В., Галимов А.И., Калитухо И.В.,

	<u>Димитриев Г.С.</u> , Сапега В.Ф., Шорникова Е.В., Aubert T., Hens Z., Яковлев Д.Р., Bayer M., Шубина Т.В., Родина А.В. <i>Влияние дисперсии формы нанокристаллов CdSe на наблюдаемую тонкую энергетическую структуру экситонов</i>
6.	<u>Крылов И.В.</u> , Дроздов К.А., Приходько К.Я., Румянцева М.Н., Рябова Л.И. <i>Структурные особенности и механизмы проводимости нанокристаллических оксидов $Ni_xCo_{3-x}O_4$</i>
7.	<u>Кузнецова М.С.</u> , Батаев М.Н., Вербин С.Ю., Игнатъев И.В., Давыдов В.Ю., Смирнов А.Н., Елисеев И.А., Колобкова Е.В. <i>Антистоксова люминесценция перовскитных нанокристаллов в стеклянных матрицах</i>
8.	<u>Леппенен Н.В.</u> , Смирнов Д.С. <i>Квантовые эффекты Зенона при оптическом измерении спинов локализованных электронов</i>
9.	<u>Свит К.А.</u> , Зарубанов А.А., Журавлев К.С. <i>Энергетическая структура и оптические свойства квантовых точек CdS, синтезированных с помощью технологии Ленгмюра – Блоджетт</i>
10.	<u>Селькин А.В.</u> , Юлдашев Н.Х. <i>Поверхностная квантово-размерная рекомбинация фотоносителей в микрокристаллах CdTe</i>
11.	<u>Смирнов А.М.</u> , Козлова М.В., Манцевич В.Н., Саиджонов Б.М., Васильев Р.Б., Днепровский В.С. <i>Нелинейно-оптический отклик коллоидного раствора нанопластинок CdSe различной концентрации</i>
12.	<u>Манцевич В.Н.</u> , <u>Смирнов Д.С.</u> <i>Ориентация током спина дырки в хиральном квазистационарном состоянии</i>

Двумерные системы

13.	<u>Афанасьев А.Н.</u> , <u>Алексеев П.С.</u> , Грешнов А.А., Семина М.А. <i>Фазовый переход между баллистическим и гидродинамическим течениями двумерных электронов в магнитном поле</i>
14.	<u>Asafov D.</u> , Gornyi I., Kachorovskii V., Tikhonov K., Zhang G. <i>Viscous flow through a finite-width slit, and the coexistence of no-slip and no-stress boundary conditions</i>
15.	<u>Бисти В.Е.</u> <i>Двумерные электроны низкой плотности в магнитном поле</i>
16.	<u>Боев М.В.</u> , <u>Ковалёв В.М.</u> <i>Квадратичный электродинамический отклик двумерных наноструктур на основе монослоев дихалькогенидов переходных металлов</i>

17.	<u>Гудина С.В.</u> , Неверов В.Н., Попов М.Р., Подгорных С.М., Шелушинина Н.Г., Якунин М.В., Дворецкий С.А., Михайлов Н.Н. <i>Гигантское расщепление Раибы в асимметричных квантовых ямах на основе HgCdTe</i>
18.	<u>Зарезин А.М.</u> , Муравьев В.М., Гусихин П.А., Кукушкин И.В. <i>Аномальное запаздывание релятивистских плазменных возбуждений в частично экранированных двумерных электронных системах</i>
19.	<u>Иванов М.С.</u> , Степанов Н.П. <i>Исследование интенсивности электрон-плазмонного взаимодействия при сближении энергии плазмона и межзонного перехода в кристаллах $(Bi_{2-x}Sb_x)Te_3$</i>
20.	<u>Лапушкин М.Н.</u> , Кузнецов Ю.А., Кулешова Т.Э. <i>Формирование 2D-полупроводникового интерметаллида K_xAu_y</i>
21.	<u>Махмудиан М.М.</u> , Энтин М.В. <i>Теория вигнеровской шестеренчатой передачи</i>
22.	<u>Неверов В.Н.</u> , Клепикова А.С., Огнева М.С., Попов М.Р., Степанова Е.А., Иванов А.А., Чарикова Т.Б. <i>Анизотропия магнитной восприимчивости и сопротивления двумерной разупорядоченной системы $Nd_{2-x}Ce_xSiO_{4+\delta}$</i>
23.	<u>Неверов В.Н.</u> , Гудина С.В., Шелушинина Н.Г., Арапов Ю.Г., Боголюбовский А.С., Клепикова А.С., Туруткин К.В., Якунин М.В. <i>Механизмы сбоя фазы для одиночных и двойных гетеропереходов в квантовых фазовых переходах плато-плато КЭХ</i>
24.	<u>Рудаков А.О.</u> , Алешкин В.Я. <i>Рекомбинация носителей заряда с испусканием плазмонов в многоямных гетероструктурах HgTe/CdHgTe</i>
25.	<u>Сафонов И.В.</u> , Свинцов Д.А. <i>Проявление эффекта кулоновского увлечения в спектрах и затухании двумерных плазмонов</i>
26.	<u>Фролов А.В.</u> , Орлов А.П., Синченко А.А., Монсо П. <i>Демонстрация коллективного движения волны зарядовой плотности под воздействием электрического поля Холла</i>
27.	<u>Шабанов А.В.</u> , Москотин М., Белосевич В., Матюшкин Я., Рыбин М., Федоров Г., Свинцов Д. <i>Оптимальная асимметрия в детекторах терагерцового излучения, основанных на транзисторах с двумерным каналом</i>

Нанофотоника

28.	<u>Полева М.А.</u> , Фризюк К.С., <u>Барышникова К.В.</u> , Богданов А.А., Петров М.И. <i>Мультипольный анализ оптического отклика бианизотропных</i>
-----	--

	<i>наноструктур</i>
29.	<u>Блошкин А.А.</u> , Якимов А.И., Двуреченский А.В. <i>Усиление чувствительности Ge/Si фотоприемников ближнего инфракрасного диапазона метаповерхностями</i>
30.	<u>Дьяков С.А.</u> , Чермошенцев Д.А., Аникин Е.В., Гиппиус Н.А. <i>Поверхностные волны Дьяконова в ограниченных средах</i>
31.	<u>Иванов А.А.</u> , Чалдышев В.В., Заварин Е.Е., Сахаров А.В., Лундин В.В., Цацульников А.Ф. <i>Резонансная брэгговская структура GaN/AlGaN</i>
32.	<u>Ушанов В.И.</u> , Иванов А.А., Берг Н.А., Снигирев Л.А., Кириленко Д.А., Яговкина М.А., Чалдышев В.В., Преображенский В.В., Путятю М.А., Семягин Б.Р., Касаткин И. А. <i>Плазмонный резонанс в композитном метаматериале $AsSb-Al_{0.6}Ga_{0.4}As_{0.97}Sb_{0.03}$</i>
33.	<u>Игошин В.Д.</u> , Никитина А.Д., Цимоха М.А., Тофтул И.Д., Петров М.И., Фризюк К.С. <i>Механизм образования исключительных точек при нарушении симметрии резонатора</i>
34.	<u>Лазаренко П.</u> , Ковалюк В., Ан П., Голиков А., Кищук Е., Якубов А., Шерченков А., Козюхин С., Гольцман Г. <i>Интегральные активные устройства нанофотоники на основе функциональных материалов Ge-Sb-Te</i>
35.	<u>Никитина А.Д.</u> , Николаева А.А., Фризюк К.С. <i>Нелинейный циркулярный дихроизм в димерах и тримерах диэлектрических наночастиц</i>
36.	<u>Павлов С.И.</u> , Дьяков С.А., Марков Д.П., Феоктистов Н.А., Фрадкин И.М., Нащекин А.В., Гиппиус Н.А., Тиходеев С.Г., Певцов А.Б. <i>Резонансные оптические особенности 2D-периодических плазмон-волноводных структур с различной геометрией решеток</i>
37.	<u>Родионов Д.А.</u> , Загороднев И.В. <i>Плазменные резонансы в экранированной двумерной электронной системе в форме диска</i>
38.	<u>Салахова Н.С.</u> , Фрадкин И.М., Дьяков С.А., Гиппиус Н.А. <i>Расчет оптических свойств муаровых метаповерхностей при помощи фурье-модального метода</i>
39.	<u>Серов Ю.М.</u> , Галимов А.И., Горопов А.А. <i>Кинетика излучения биэкситонного каскада в одиночной квантовой точке InAs/GaAs в высокочастотном микрорезонаторе</i>
40.	<u>Смагина Ж.В.</u> , Зиновьев В.А., Степихова М.В., Перетокин А.В., Родякина Е.Е., Кучинская П.А., Барышникова К.В., Сергаева О.Н.,

	Дьяков С.А., Новиков А.В. <i>Диэлектрические резонаторы со встроенными GeSi квантовыми точками</i>
41.	Степихова М.В., Вербус В.А., Барышникова К.В., Петров М.И., Дьяков С.А., Юрасов Д.В., Шенгуров Д.В., Смагина Ж.В., Родякина Е.Е., Новиков А.В. <i>Резонансные явления и коллективные взаимодействия в спектрах фотолюминесценции одиночных цилиндрических резонаторов и их массивов, сформированных на кремниевых структурах с наноструктурами Ge(Si)</i>
42.	Степихова М.В., Перетокин А.В., Дьяков С.А., Юрасов Д.В., Шалеев М.В., Яблонский А.Н., Смагина Ж.В., Родякина Е.Е., Зиновьев В.А., Новиков А.В. <i>Фотонные моды в люминесцентном отклике двумерных фотонных кристаллов, сформированных на кремниевых структурах с наноструктурами Ge(Si)</i>
43.	Уткин Д.Е., Шкляев А.А. <i>Особенности резонансного отражения для решёток Ge-дисков на подложках Si, обусловленные междисковым расстоянием</i>
44.	Уточкин В.В., Фадеев М.А., Румянцев В.В., Морозов С.В., Гавриленко В.И., Кудрявцев К.Е., Михайлов Н.Н., Дворецкий С.А. <i>Стимулированное излучение на длинах волн 2.45 и 2.75 мкм в HgCdTe структурах с КЯ при комнатной температуре</i>
45.	Фрадкин И.М., Дьяков С.А., Гиппиус Н.А. <i>Гомогенизация резонансных метаматериалов</i>
46.	Фризиук К.С., Мелик-Гайказян Е., Choi J.-H., Park H.-G., Петров М.И., Кившарь Ю. <i>Нелинейный циркулярный дихроизм в димерах цилиндрических наночастиц из арсенида галлия</i>
47.	Фурасова А.Д., Макаров С.В. <i>Ми-резонансный транспортный слой для увеличения поглощения света и эффективности перовскитных солнечных элементов</i>
48.	Иванов А.А., Чалдышев В.В., Ушанов В.И., Заварин Е.Е., Сахаров А.В., Лундин В.В., Цацульников А.Ф. <i>Критический беспорядок в резонансных брэгговских структурах InGaN/GaN</i>
49.	Юрасов Д.В., Байдакова Н.А., Яблонский А.Н., Шалеев М.В., Дьяков С.А., Родякина Е.Е., Новиков А.В. <i>Усиление фотолюминесценции Ge/Si(001) слоев за счет взаимодействия с модами фотонных кристаллов</i>
50.	Яблонский А.Н., Новиков А.В., Степихова М.В., Юрасов Д.В.,

	Шалеев М.В., Петров М.И. <i>Спектрокинетические характеристики люминесценции двумерных фотонных кристаллов и ми-резонаторов на основе SiGe-структур с Ge(Si) наноструктурами</i>
Топологические изоляторы	
51.	Алигулиева Х.В., Абдуллаев Н.А., Алиев З.С., Амирасланов И.Р., Джахангирли З.А., Мамедов Н.Т., Чулков Е.В. <i>Рамановское рассеяние в соединениях $MnBi_2Te_4$ и (Bi_2Te_3)</i>
52.	Овешников Л.Н., Давыдов А.Б., Мехия А.Б., Риль А.И., Маренкин С.Ф., Аронзон Б.А. <i>Линейное магнетосопротивление в поликристаллах дираковского полуметалла $(Cd_{1-x}Mn_x)_3As_2$</i>
53.	Казаков А.С., Галеева А.В., Артамкин А.И., Иконников А.В., Чмырь С.Н., Дворецкий С.А., Михайлов Н.Н., Банников М.И., Данилов С.Н., Рябова Л.И., Хохлов Д.Р. <i>Вклад состояний на интерфейсах в терагерцовую фотопроводимость в структурах на основе $Hg_{1-x}Cd_xTe$ с инверсным спектром</i>
54.	Кахраманов К.Ш., Кахраманов С.Ш., Абдуллаев Н.А., Абдуллаев Ю.А., Алигулиева Х.В., Кахраманов А.Ш. <i>Высокотемпературные осцилляции магнетосопротивления в слоистых кристаллах Bi_2Te_3, легированных Си или Ni</i>
55.	Минакова В.Е., Кон И.А., Лукманова Р.М., Зайцев-Зотов С.В. <i>Влияние одноосного растяжения на проводимость топологически нетривиального квазиодномерного проводника $TaSe_3$</i>
56.	Ниязов Р.А., Крайнов И.В., Аристов Д.Н., Качоровский В.Ю. <i>Дробовой шум в интерферометрах Ааронова – Бома</i>
57.	Рыжков М.С., Худайбердиев Д.А., Козлов Д.А., Квон З.Д., Михайлов Н.Н., Дворецкий С.А. <i>Краевой и объемный транспорт в двумерном топологическом изоляторе на основе квантовой ямы $CdHgTe$</i>
58.	Трухин В.Н., Мустафин И.А., Алексеев П.А., Kusmartsev F.V., Kusmartseva A., Liu Y., Zhang B., Luo Y. <i>Исследование фототоков в квантовых ямах α-Sn/Ge посредством регистрации терагерцового излучения</i>
59.	Хомицкий Д.В., Лаврухина Е.А., Конаков А.А. <i>Микроскопическая модель локализованных состояний на крае двумерного топологического изолятора в присутствии магнитных барьеров</i>

ДЛЯ ЗАМЕТОК